

Ген. ВЧ - генератор высокой частоты;
 НГ - непрерывная генерация;
 ВНУТР. АМ - внутренняя амплитудная модуляция;
 ВКЛ. - включение;
 ОТКЛ. - отключение;
 Пл. об. - плата объединительная;
 Мод. НЧ - модулятор низкой частоты;
 ВКЛ. АМ ВНУТР. - включение амплитудной модуляции внутренней;
 ВКЛ. АМ ВНЕШН. - включение амплитудной модуляции внешней;
 ВНЕШН. АМ - внешняя амплитудная модуляция;
 СИНХР. - синхронизация;
 Откл. вых. - отключение выхода;
 ИНД. - индикация;
 ДУ - дистанционное управление;
 ИНД. Ц - индикатор цифровой;
 ДФ вых. - дешифратор выхода;
 Р - разряд;
 Ат - аттенуатор;
 ШК - штырь контрольный;
 РАССТР. - расстройка;
 АПЧ - автоматическая подстройка частоты;
 ДП - делитель программируемый;
 Ф - фильтр;
 У-М - усилитель-модулятор;
 УС - устройство соединительное;
 Уз П - узел печатный;
 УУ - устройство управления;
 БП - блок питания;
 ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь;
 Ус. стаб. - усилитель стабилизаторов;
 Б - база;
 Э - эмиттер;
 К - коллектор.

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ
 ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ

См. рис. I на вкладке I.

Перечень элементов 3.260.018 ПЭЗ

Обозначение на рис. I	Наименование	Количество
В1	Переключатель ЦДМ1-1	1
В2	Тумблер ТЗ	1
Ш3, Ш4	Вилка РЛМИ2-(12К; 2Л; 2М) ШС-Оп (3К+1М+1Л+6К+1М+1Л+3К)В	2
Ш5	Розетка приборно-кабельная СР-50-113Ф	1
Ш6	Вилка кабельная СР-50-111Ф	1

Обозначение на рис. I	Наименование	Количество
Ш7	Розетка приборно-кабельная СР-50-111	1
Ш8	Розетка приборно-кабельная СР-50-113Ф	1
Ш9	Вилка кабельная СР-50-111Ф	1
Ш10	Розетка приборно-кабельная СР-50-111	1
Ш11	Вилка кабельная СР-50-111Ф	1
Ш12	Розетка приборно-кабельная СР-50-113Ф	1
Ш13, Ш14	Розетка приборно-кабельная СР-50-111	2
Ш15-Ш18	Вилка РЛМИ2-(12К; 2Л; 2М) ШС-Оп (3К+1М+1Л+6К+1М+1Л+3К)В	4
Ш19, Ш20	Розетка РП15-15ГВ-В	2
Ш21	Вилка РП10-11	1
Ш22, Ш23	Вилка кабельная СР-50-111Ф	2
Ш24	Розетка 3.647.040	1
Ш25	Вилка РП10-7	1
У1	Модулятор НЧ 5.081.010	1
У2	Дешифратор выхода 5.109.000	1
У3	Делитель программируемый 5.408.009	1
У4	Детектор фазовый 5.404.016	1
У5	Генератор ВЧ 5.410.011	1
У6	Фильтр 5.067.028	1
У7	Усилитель-модулятор 5.002.008	1
У8	Устройство соединительное 5.282.489	1
У9	Устройство управления 5.139.012	1
У10	Индикатор цифровой 5.174.003	1
У11	Аттенуатор 2.243.031-02	1
У12	Блок питания 2.087.034	1
	<u>Плата объединительная 5.282.511</u>	
Ш1, Ш2	Розетка СНП14-72/120x10P-19-В	2
	<u>Узел печатный 5.282.226</u>	
С1	Конденсатор КД-1-М75-15 пФ ±10 %-3	1
Ш1	Разъем конструктивный	1

Обозначение на рис.2	Наименование	Количество
Конденсаторы:		
C1-C5, C7-C11	КТП-2Аа-Н70-6800 пФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	10
C12	КТП-2Аа-М750-100 пФ ⁺¹⁰ %	1
C13-C15	КТП-2Аа-Н70-6800 пФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	3
C16-C20,	КДО-2-Н70-2200 пФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	10
C22-C26	КДО-2-М1500-100 пФ ⁺²⁰ %	1
C27	КДО-2-Н70-2200 пФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	3
C28-C30	КДО-2-Н70-2200 пФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	3
C31-C35,	КТП-2Аа-Н70-6800 пФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	10
C37-C41	КТП-2Аа-М750-100 пФ ⁺¹⁰ %	1
C42	КТП-2Аа-Н70-6800 пФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	3
C43-C45	КТП-2Аа-Н70-6800 пФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	3
Катушки индуктивности:		
L1-L5	5.777.014	5
L7, L8	5.777.014-02	2
L9	5.777.014-03	1
L10	5.777.014-02	1
L11	5.777.014-04	1

Обозначение на рис.2	Наименование	Количество
L12	5.777.014-01	1
L13-L15	5.777.014-04	3
L16-L20	5.777.014	5
L22, L23	5.777.014-02	2
L24	5.777.014-03	1
L25	5.777.014-02	1
L26	5.777.014-04	1
L27	5.777.014-01	1
L28-L30	5.777.014	3
Ш1, Ш1а	Розетка РЛМИ2 (12К; 2М; 2Н) Шс-ОП (3К+1М+1Н+6К+1М+1Н+3К)В	2
	Плата объединительная 5.282.224	
C1, C2	Конденсатор К50-29-6, 3В- -2200 мкФ	2
Ш1-Ш5	Розетка СНП14-72/120x10P- -19-В	5
Ш6	Розетка СНП37-24/57,5x10P- -19-В	1

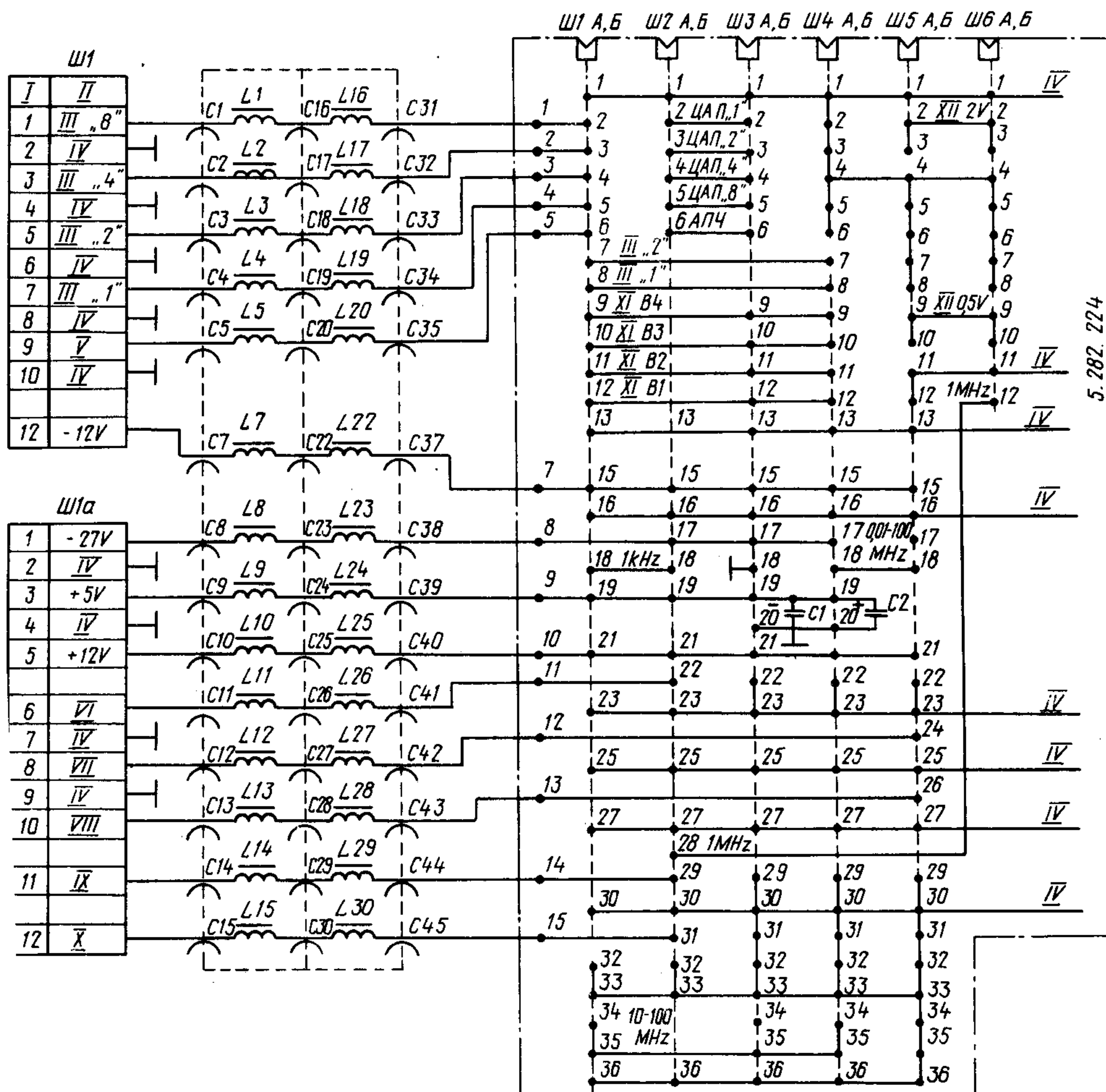


Рис.2. Схема электрическая принципиальная устройства соединительного 5.282.489 ЭЗ:

I - контакт; II - цепь; III - код; IV - корпус; V -

загрузка; VI - контроль синхронизации; VII - модулирующее напряжение; VIII - уровень; IX - включение кварца; X - перестройка; XI - включение; XII - выход

Перечень элементов 5.410.011 ПЭЗ

Обозначение на рис. 3 **	Наименование	Количество
Резисторы:		
R1	ОМЛТ-0,125-3,3 кОм±10 %	1
R2	ОМЛТ-0,125-33 кОм±10 %	1
R3	ОМЛТ-0,125-II кОм±1 %	1
R4	ОМЛТ-0,125-100 кОм±10 %	1
R5	ОМЛТ-0,125-22 кОм±10 %	1
R6, R7	ОМЛТ-0,125-27 кОм±10 %	2
R8	СП4-IV-22 кОм-А	1
R9	ОМЛТ-0,125-43 кОм±5 %	1
R10	ОМЛТ-0,125-560 кОм±10 %	1
R11	ОМЛТ-0,125-100 кОм±10 %	1
R12*	ОМЛТ-0,125-24 кОм±5 %	1
R13	ОМЛТ-0,125-5,6 кОм±10 %	1
R14	ОМЛТ-0,125-330 Ом±10 %	1
R15	СП4-IV-22 кОм-А	1
R16	ОМЛТ-0,125-100 кОм±10 %	1
R17	ОМЛТ-0,125-15 кОм±10 %	1
R18	ОМЛТ-0,125-68 кОм±10 %	1
R19	ОМЛТ-0,125-220 Ом±10 %	1
R20	ОМЛТ-0,125-22 кОм±10 %	1
R21	ОМЛТ-0,125-560 Ом±10 %	1
R22	ОМЛТ-0,125-12 кОм±10 %	1
R23, R24	ОМЛТ-0,125-33 кОм±10 %	2
R25	ОМЛТ-0,125-220 Ом±10 %	1
R26	ОМЛТ-0,125-22 кОм±10 %	1
R27	ОМЛТ-0,125-33 Ом±10 %	1
R28	ОМЛТ-0,125-220 Ом±10 %	1
R29	СП4-IV-I кОм-А	1
R30	ОМЛТ-0,125-68 кОм±10 %	1
R31	ОМЛТ-0,125-33 кОм±10 %	1
R32	ОМЛТ-0,125-150 кОм±10 %	1
R33	ОМЛТ-0,125-33 кОм±10 %	1
R34	ОМЛТ-0,125-100 кОм±10 %	1
R35	ОМЛТ-0,125-220 Ом±10 %	1
R36	ОМЛТ-0,125-3,3 кОм±10 %	1
R37	ОМЛТ-0,25-I,5 кОм±10 %	1
R38	ОМЛТ-0,125-33 Ом±10 %	1
R39, R40	ОМЛТ-0,125-220 Ом±10 %	2
R41	ОМЛТ-0,125-3,3 кОм±10 %	1
R42	ОМЛТ-0,25-I,5 кОм±10 %	1
R43	ОМЛТ-0,120-100 Ом±10 %	1
R44, R45	ОМЛТ-0,125-680 Ом±10 %	2
R46	ОМЛТ-0,125-100 Ом±10 %	1
R47	ОМЛТ-0,25-I,5 кОм±10 %	1
R48	ОМЛТ-0,125-33 Ом±10 %	1
R49, R50	ОМЛТ-0,125-680 Ом±10 %	2
R51, R52	ОМЛТ-0,125-I,5 кОм±10 %	2
R53	ОМЛТ-0,125-33 Ом±10 %	1
R54, R55	ОМЛТ-0,125-I кОм±10 %	2
Конденсаторы:		
C1	КМ-56-Н90-0,047 мкФ ⁺⁸⁰ / ₋₂₀ %	1
C2	К50-29-63 В-100 мкФ	1
C3	КМ-56-Н90-0,1 мкФ ⁺⁸⁰ / ₋₂₀ %	1

*R15, 22 кОм - подбираются при регулировании.

** См. рис.3 на вкладке I

Обозначение на рис. 3	Наименование	Количество
C4	К50-29-63 В-100 мкФ	1
C5	КМ-56-Н90-0,1 мкФ ⁺⁸⁰ / ₋₂₀ %	1
C6, C7	КМ-5А-Н90-I мкФ	2
C8	КМ-56-Н90-0,047 мкФ ⁺⁸⁰ / ₋₂₀ %	1
C9	КМ-6А-Н90-I мкФ	1
C10	КМ-56-Н90-0,047 мкФ ⁺⁸⁰ / ₋₂₀ %	1
C11	КМ-56-М1500-820 пФ±10 %	1
C12	КД-I-M47-2,7 пФ±0,4-I	1
C13-C24	КМ-56-Н90-0,047 мкФ ⁺⁸⁰ / ₋₂₀ %	12
C25, C26	КМ-56-Н90-0,1 мкФ ⁺⁸⁰ / ₋₂₀ %	2
C27	КМ-56-Н90-0,047 мкФ ⁺⁸⁰ / ₋₂₀ %	1
Катушки индуктивности ВЧ:		
L1	4.777.026	1
L2	М-III-40 4.777.062-09	1
L3	4.777.026-0I	1
L4	М-III-40 4.777.062-09	1
L5	4.777.026-02	1
L6	М-III-40 4.777.062-09	1
L7	4.777.026-03	1
L8	М-III-40 4.777.062-09	1
В1-В4	Геркон МКА-1050I	4
Диоды полупроводниковые		
Д1-Д12	2В117А	12
Д13-Д20	2В104Б	8
Микросхемы		
МС1, МС2	143К11	2
МС3	Диодная матрица 2ДС523АМ, дополнение I	1
МС4	564АУ5	1
МС5	149К11В	1
МС6, МС7	Диодная матрица 2ДС523АМ, дополнение I	2
Р1-Р4	Катушка реле 5.680.003	4
Транзисторы:		
Т1	2Т208Е	1
Т2	2П103В	1
Т3, Т4	2П303В	2
Т5-Т8	2П307Т	4
Т9	2Т363А	1
Т10	2Т371А	1
Т11	2Т363А	1
Т12, Т13	2Т371А	2
Т14	2Т363А	1
Ш1, Ш2	Разъем конструктивный	2

ФИЛЬТР

Перечень элементов 5.067.028 ПЭЗ

Обозначение на рис. 4*	Наименование	Количество
Резисторы:		
R1	ОМЛТ-0,125-2,2 кОм±10 %	1
R2	ОМЛТ-0,125-220 Ом±10 %	1
R3	ОМЛТ-0,25-I,5 кОм±10 %	1

Обозначение на рис. 4	Наименование	Количество
R4	OMЛТ-0,125-2,2 кОм±10 %	1
R5, R6	OMЛТ-0,125-100 Ом±10 %	2
R7-R9	OMЛТ-0,125-1 кОм±10 %	3
RI0	OMЛТ-0,125-10 кОм±10 %	1
RII	OMЛТ-0,125-75 Ом±5 %	1
RI2	OMЛТ-0,25-1,2 кОм±10 %	1
RI3	OMЛТ-0,125-680 Ом±10 %	1
RI4	OMЛТ-0,126-5,6 кОм±10 %	1
RI5	OMЛТ-0,125-3,3 кОм±10 %	1
RI6	OMЛТ-0,125-33 кОм±10 %	1
RI7 ^X	OMЛТ-0,125-20 Ом±5 %	1
RI8	OMЛТ-0,125-10 кОм±10 %	1
RI9	OMЛТ-0,125-3,3 кОм±10 %	1
R20, R21	OMЛТ-0,125-220 Ом±10 %	2
R22	OMЛТ-0,125-33 кОм±10 %	1
R23	OMЛТ-0,125-3,3 кОм±10 %	1
R24	OMЛТ-0,125-33 Ом±10 %	1
R25	OMЛТ-0,125-220 Ом±10 %	1
R26	OMЛТ-0,125-22 Ом±10 %	1
R27	OMЛТ-0,25-1 кОм±10 %	1
R28	OMЛТ-0,125-1,2 кОм±10 %	1
R29	OMЛТ-0,125-120 Ом±10 %	1
Конденсаторы:		
CI	KM-56-H90-0,047 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	1
C2	K53-I4-6,3 B-100 мкФ ⁺²⁰ % вариант I	1
C3	K7I-5-0,027 мкФ±5 %	1
C4	K7I-5-0,012 мкФ±5 %	1
C5	KM-56-MI500-5600 пФ±5 %	1
C6	KM-56-MI500-2700 пФ±5 %	1
C7	K7I-5-0,027 мкФ±5 %	1
C8	K7I-5-0,012 мкФ±5 %	1
C9	KM-56-MI500-5600 пФ±5 %	1
CI0	KM-56-MI500-2700 пФ±5 %	1
CI1	KM-56-H90-0,015 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	1
CI2	KM-56-MI500-1000 пФ±20 %	1
CI3	KM-56-H90-0,047 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	1
CI4	KM-56-MI500-2200 пФ±5 %	1
CI5	KM-56-MI500-1200 пФ±5 %	1
CI6	KM-56-M47-560 пФ±5 %	1
CI7	KM-56-M47-270 пФ±5 %	1
CI8	KM-56-MI500-2200 пФ±5 %	1
CI9	KM-56-MI500-1200 пФ±5 %	1
C20	KM-56-M47-560 пФ±5 %	1
C21	KM-56-M47-270 пФ±5 %	1
C22, C23	KM-6A-H90-I мкФ	2
C24	K53-I4-30B-22 мкФ±20 %	1
C25	KM-6A-H90-I мкФ	1
C26	K53-I4-30B-22 мкФ±20 %	1
C27, C28	KM-56-0,047 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	2
C29	K53-I4-30B-22 мкФ±20 %	1
C30	KM-56-M47-220 пФ±5 %	1
C31	KM-56-M47-100 пФ±5 %	1

*22 Ом - подбирается при регулировании.

Обозначение на рис. 4	Наименование	Количество
C32	KM-56-M47-33 пФ±5 %	1
C33	KII-M47-I5 пФ±5 %-3	1
C34	KM-56-M47-220 пФ±5 %	1
C35	KM-56-M47-100 пФ±5 %	1
C36	KM-56-M47-33 пФ±5 %	1
C37	KII-M47-I5 пФ±5 %-3	1
C38	KII-6A-H90-I мкФ	1
C39-C41	KM-56-H90-0,1 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ % Катушки индуктивности ВЧ:	3
LI	4.777.028-04	1
L2	4.777.028-03	1
L3	4.777.028-02	1
L4, L5	4.777.028-01	2
L6	4.777.028	1
L7	4.777.027-03	1
L8, L9	4.777.027-02	2
LI0	4.777.027-01	1
LI1	4.777.027	1
LI2	4.777.026-04	1
BI-B3	Геркон МКА-10501	3
DI	Диод полупроводниковый 2Д510А Микросхемы:	1
MC1	564ЛН2	1
MC2	190KI2	1
MC3	564ЛА7	1
MC4	564ЛН2	1
MC5	190KI2	1
MC6	193IE3	1
MC7	190KI2	1
MC8, MC9	133IE2	2
MC10	190KI2	1
MC11	133КП5	1
MC12	133ЛА8	1
MC13	143KI1	1
MC14, MC15	190KI2	2
MC16	143KI1	1
PI-P3	Катушка реле 5.680.003 Транзисторы:	3
TI, T2	2Т368А	2
T3, T4	2Т312Б	2
T5	2Т326Б	1
T6	2П307Г	1
T7	2Т368А	1
T8	2Т363А	1
YI-Y3	Дешифратор фильтра 3.440.000	3
III, III2	Разъем конструктивный	2

ДЕШИФРАТОР ФИЛЬТРА

Перечень элементов 3.440.000 ПЭЗ

Обозначение на рис. 5	Наименование	Количество
Резисторы:		
RI	600 Ом±5 %	1
R2	4 кОм±5 %	1
R3	3 кОм±5 %	1

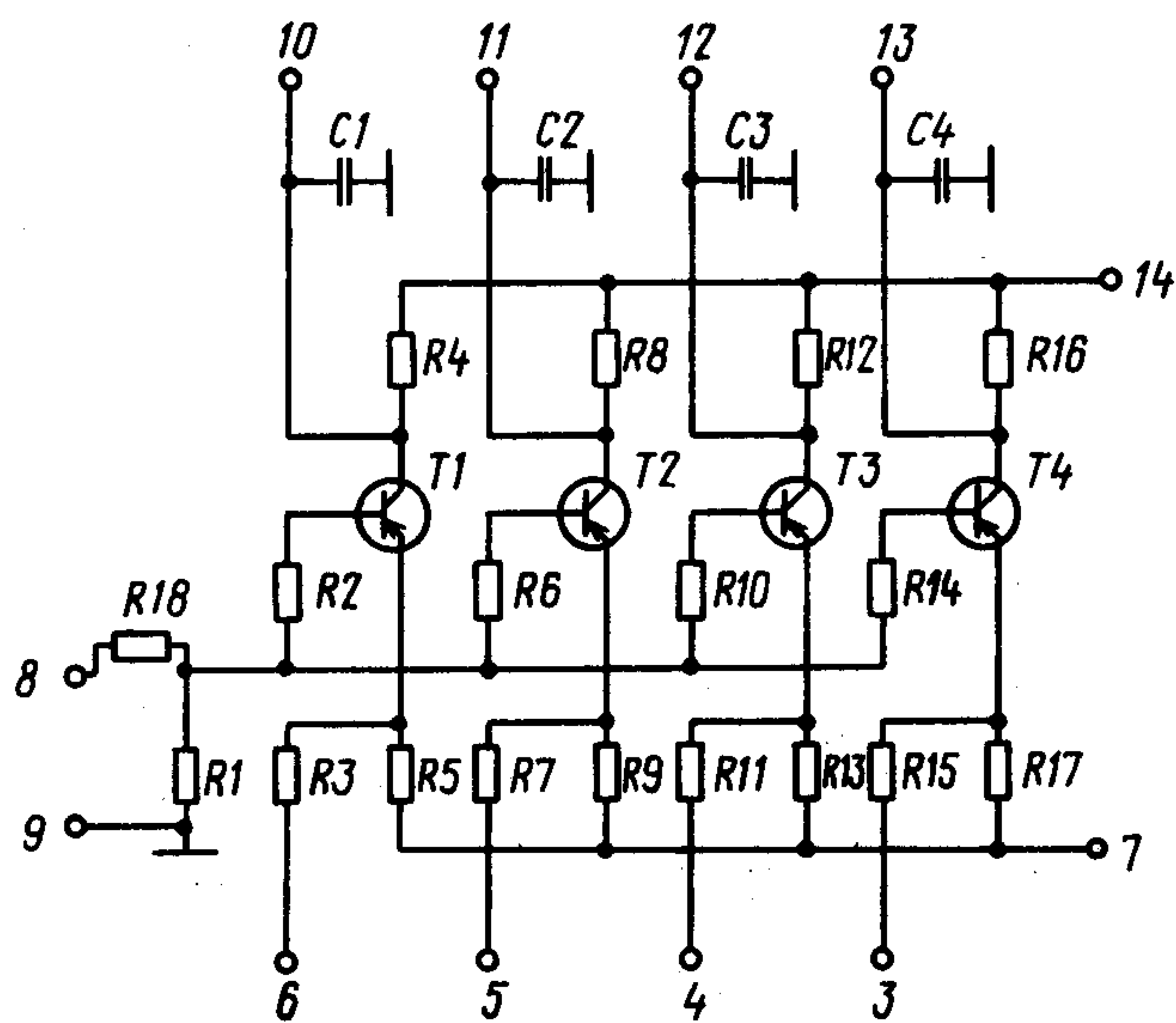


Рис.5. Схема электрическая принципиальная дешифратора фильтра 3.440.000 ЭЗ

Продолжение

Обозначение на рис.5	Наименование	Количество
R4	50 кОм±5 %	I
R5	3 кОм±5 %	I
R6	4 кОм±5 %	I
R7	3 кОм±5 %	I
R8	50 кОм±5 %	I
R9	3 кОм±5 %	I
R10	4 кОм±5 %	I
R11	3 кОм±5 %	I
R12	50 кОм±5 %	I
R13	3 кОм±5 %	I
R14	4 кОм±5 %	I
R15	3 кОм±5 %	I
R16	50 кОм±5 %	I
R17	3 кОм±5 %	I
R18	600 Ом±5 %	I
C1-C4	Конденсатор К10-17-3В-Н90-0,01 мкФ-I	4
T1-T4	Транзистор 2Т102Г-I	4

Примечание. R1-R18 - исполнение напылением.

УСИЛИТЕЛЬ-МОДУЛЯТОР

Перечень элементов 5.002.008 ПЭЗ

Обозначение на рис.6*	Наименование	Количество
Резисторы:		
R1	ОМЛТ-0,125-22 кОм±10 %	I
R2	ОМЛТ-0,125-3,9 кОм±10 %	I
R3	ОМЛТ-0,125-680 Ом±10 %	I
R4	ОМЛТ-0,125-12 кОм±10 %	I
R5	ОМЛТ-0,125-10 кОм±10 %	I
R6	ТВ-2-250А	I
R7	ОМЛТ-0,125-10 Ом±10 %	I
R8	ОМЛТ-0,125-100 Ом±10 %	I
R9	ОМЛТ-0,125-300 Ом±5 %	I

Продолжение

Обозначение на рис.6	Наименование	Количество
R9a	ОМЛТ-0,125-100 Ом±10 %	I
R10	ОМЛТ-0,125-5I Ом±5 %	I
R10a	ОМЛТ-0,125-220 Ом±10 %	I
R11	ОМЛТ-0,125-5I Ом±5 %	I
R11a	ОМЛТ-0,125-180 Ом±5 %	I
R12	ОМЛТ-0,125-I МОм±10 %	I
R13	СП4-1В-10 кОм-A	I
R14	СП4-1В-680 Ом-A	I
R15*	ОМЛТ-0,125-180 Ом±10 %	I
R15a, R15б	ОМЛТ-0,125-8,2 кОм±10 %	2
R16	ОМЛТ-0,125-3,3 кОм±10 %	I
R17	ОМЛТ-0,125-560 Ом±10 %	I
R18	ОМЛТ-0,125-470 Ом±10 %	I
R19	ОМЛТ-0,125-560 Ом±10 %	I
R20	ОМЛТ-0,125-27 Ом±10 %	I
R21	СП4-1В-I,5 кОм-A	I
R22	ОМЛТ-0,125-5,1 кОм±5 %	I
R22a, R22б	ОМЛТ-0,125-560 Ом±10 %	2
R23	ОМЛТ-0,125-390 Ом±10 %	I
R24	ОМЛТ-0,125-100 Ом±10 %	I
R24a	ОМЛТ-0,125-62 Ом±5 %	I
R25	ОМЛТ-0,125-100 Ом±10 %	I
R25a**	ОМЛТ-0,125-I,2 кОм±10 %	I
R26, R27	ОМЛТ-0,125-390 Ом±10 %	2
R27a**	ОМЛТ-0,125-33 Ом±10 %	I
R27б	ОМЛТ-0,125-5I Ом±5 %	I
R28, R29	ОМЛТ-0,125-390 Ом±10 %	2
R30	ОМЛТ-0,125-2 кОм±5 %	I
R31	ОМЛТ-0,125-I,2 кОм±10 %	I
R32	ОМЛТ-0,125-I,1 кОм±5 %	I
R33	ОМЛТ-0,125-5,6 кОм±10 %	I
R34	СП4-1В-4,7 кОм-A	I
R35	ОМЛТ-0,125-5,6 кОм±10 %	I
R36	ОМЛТ-0,125-270 Ом±10 %	I
R36a	ОМЛТ-0,125-10 Ом±10 %	I
R37	ОМЛТ-0,125-270 Ом±10 %	I
R38	ОМЛТ-0,25-10 Ом±10 %	I
R39	С2-10-2-49,9 Ом±I %-B	I
R40	ОМЛТ-0,125-33 Ом±10 %	I
R41	ОМЛТ-0,125-62 Ом±5 %	I
R42	ОМЛТ-0,125-270 Ом±10 %	I
R43	ОМЛТ-0,125-33 Ом±10 %	I
R44	ОМЛТ-0,125-62 Ом±5 %	I
R45	ОМЛТ-0,125-270 Ом±10 %	I
R46	ОМЛТ-0,125-33 Ом±10 %	I
R47	ОМЛТ-0,125-62 Ом±5 %	I
R48	ОМЛТ-0,125-270 Ом±10 %	I
R49	ОМЛТ-0,125-33 Ом±10 %	I
R50	ОМЛТ-0,125-62 Ом±5 %	I
R51	ОМЛТ-0,125-270 Ом±10 %	I
R52	ОМЛТ-0,125-33 Ом±10 %	I

*220, 270 Ом - подбираются при регулировании.

**15, 62 Ом - подбираются при регулировании.

***0,1,2 кОм - подбираются при регулировании.

* См. рис. 6 на вкладке 2

Обозначение на рис.6	Наименование	Количество
R53	ОМЛТ-0,125-62 Ом±5 %	1
R54	ОМЛТ-0,125-270 Ом±10 %	1
R55	ОМЛТ-0,125-33 Ом±10 %	1
R56	ОМЛТ-0,125-62 Ом±5 %	1
R57	ОМЛТ-0,125-270 Ом±10 %	1
R58	ОМЛТ-0,125-33 Ом±10 %	1
R59	ОМЛТ-0,125-62 Ом±5 %	1
Конденсаторы:		
C1	КМ-6А-Н90-2,2 мкФ	1
C2	КМ-6Б-Н90-2,2 мкФ	1
C3, C3a	КМ-56-Н90-0,015 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	2
C4	КМ-6А-Н90-1 мкФ	1
C4a	КМ-56-М1500-1000 пФ±10 %	1
C5	КМ-6А-Н90-1 мкФ	1
C5a	КМ-56-М47-27 пФ±10 %	1
C6	КМ-6Б-Н90-2,2 мкФ	1
C7, C8	КМ-6А-Н90-1 мкФ	2
C9	КМ-6Б-Н90-2,2 мкФ	1
C9a, C9б	КМ-56-Н90-0,015 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	2
C10	КМ-56-М1500-1000 пФ±10 %	1
C10a	КД-1-П33-1,5 пФ±0,4 пФ-3	1
C11-C13	КМ-6А-Н90-1 мкФ	3
C14	КМ-56-Н90-0,1 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	1
C15	К50-29-16В-100 мкФ	1
C16-C21	КМ-6А-Н90-1 мкФ	6
C22	КМ-6Б-Н90-2,2 мкФ	1
C23	К50-29-16В-100 мкФ	1
C23a	КД-1-М47-15 пФ±10 %-3	1
C23б	КД-1-М47-12 пФ±10 %-3	1
C24, C25	КМ-56-Н90-0,015 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	2
C26	КМ-56-Н90-0,1 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	1
C26a	КМ-6А-Н90-1 мкФ	1
C26б	КД-1-М47-12 пФ±10 %-3	1
C28	КМ-56-Н90-0,015 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	1
C29, C29a	КМ-6А-Н90-1 мкФ	2
C30	КМ-56-Н90-0,015 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	1
C31	К53-14-16В-10 мкФ±20 %	1
C32, C33	КМ-56-Н90-0,015 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	2
C35	К53-14-16В-10 мкФ±20 %	1
Д1-Д6	Диод полупроводниковый КД514А	6
Катушки индуктивности ВЧ		
L1, L2	КО-Ш-0,3 4.777.093 Сп	2
L3	4.777.018	1
МС1	Микросхема 544УД1А	1
Транзисторы:		
T1	2Т312Б	1
T2	2Т368А	1
T3	2Т363А	1
T4	2Т368А	1
T5	2Т363А	1
T6	2Т368А	1
T7	2Т363А	1
T8	2Т368А	1
T9	2Т363А	1
T10	2Т368А	1

Обозначение на рис.6	Наименование	Количество
T11	2Т363А	1
T12	2Т368А	1
T13	2Т363А	1
T14	2Т368А	1
T15	2Т363А	1
T16	2Т368А	1
T17	2Т363А	1
T18	2Т368А	1
T19	2Т363А	1
У1	Модулятор 3.430.000	1
У2-У4	Повторитель эмиттерный 3.426.000	3
Ш1	Разъем конструктивный	1

ВНИМАНИЕ!

В данном приборе на плате усилителя-модулятора 5.002.008 могут быть произведены следующие изменения: У3, У4 3.426.000 могут быть заменены на 3.426.000-02; У2 3.426.000 может быть заменен на 3.426.000-01, резистор R1 ОМЛТ-0,125-22 кОм±10 % может быть исключен; R20 ОМЛТ-0,125-27 Ом±10 % может быть заменен на ОМЛТ-0,125-10 Ом±10 %.

В микросборке 3.426.000-01 в отличие от 3.426.000 вместо транзисторов Т1, Т4 2Т3123А-2 установлены 2Т364А-2, резистор R4 - 100 Ом закорочен, R2 - 100 Ом заменен на 50 Ом.

В микросборке 3.426.000-02 в отличие от 3.426.000 транзисторы Т1, Т4 2Т3123А-2 заменены на 2Т363А и установлены непосредственно на плату 5.002.008.

МОДУЛЯТОР

Перечень элементов 3.430.000 ПЭЗ

Обозначение на рис.7	Наименование	Количество
Резисторы:		
R1	1 кОм±5 %	1
R2	8 кОм±5 %	1
R3	6 кОм±5 %	1
R4	200 Ом±2 %	1
R5	4,7 кОм±5 %	1
R6	200 Ом±2 %	1
R8	200 Ом±2 %	1
R9	4 кОм±2 %	1
R10	1,5 кОм±2 %	1
R11	50 Ом±2 %	1
R13	200 Ом±2 %	1
R14	360 Ом±2 %	1
R16	4 кОм±2 %	1
R17	4 кОм±2 %	1

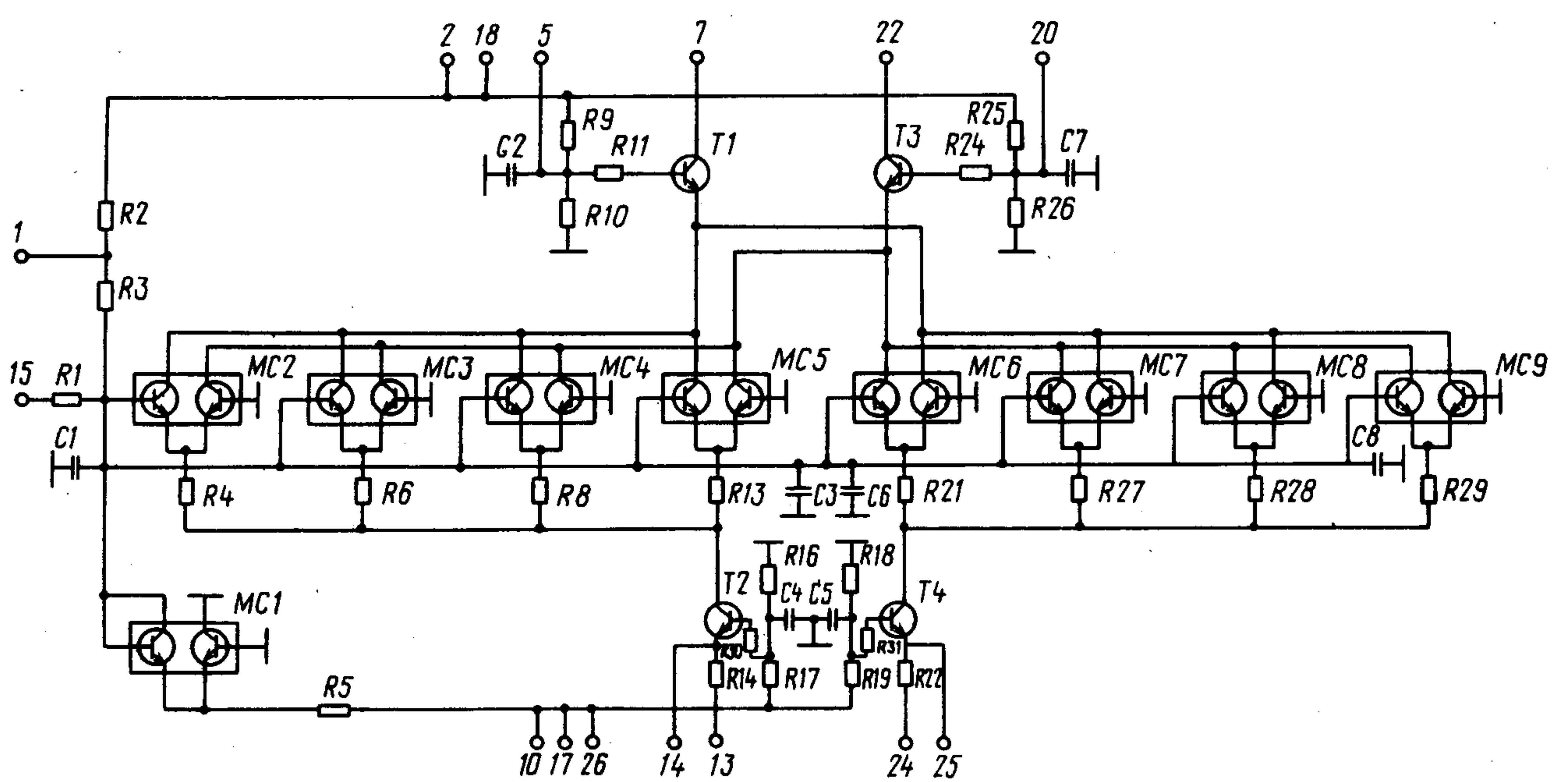


Рис.7. Схема электрическая принципиальная модуля-
тора 3.430.000 ЭЗ.

Выводы 3,4,6,8,9,11,12,16,19,21,23,28 соединить
с корпусом.

Продолжение

Обозначение на рис.7	Наименование	Коли- чество
R18	4 кОм±2%	1
R19	4 кОм±2%	1
R21	200 Ом±2%	1
R22	360 Ом±2%	1
R24	50 Ом±2%	1
R25	4 кОм±2%	1
R26	1,5 кОм±2%	1
R27	200 Ом±2%	1
R28	200 Ом±2%	1
R29	200 Ом±2%	1
R30, R31	50 Ом±2%	2
Конденсаторы:		
C1	K10-I7-2B-M75-100 пФ±10%-I	1
C2	K10-I7-2B-H90-0,01 мкФ-I	1
C3	K10-I7-2B-M75-100 пФ±10%-I	1
C4, C5	K10-I7-2B-H90-0,01 мкФ-I	2
C6	K10-I7-2B-M75-100 пФ±10%-I	1
C7	K10-I7-2B-H90-0,01 мкФ-I	1
C8	K10-I7-2B-M75-100 пФ±10%-I	1
MC1-MC9	Транзисторная сборка 2ТС396А-I	9
T1-T4	Транзистор 2Т396А-2	4

Примечание. R1-R31 - исполнение напылением.

ПОВТОРИТЕЛЬ ЭМИТТЕРНЫЙ

Перечень элементов

3.426.000 ПЭЗ

Обозначение на рис.8	Наименование	Коли- чество
Резисторы:		
R1	560 Ом±5%	1
R2	100 Ом±5%	1
R3	1,6 кОм±5%	1
R4	100 Ом±5%	1
R5	820 Ом±5%	1
R6	820 Ом±5%	1
R7	100 Ом±5%	1
R8	1,6 кОм±5%	1
R9	820 Ом±5%	1
R10	820 Ом±5%	1
C1-C6	Конденсатор K10-I7-2B-H90-0,01 мкФ-I	6
Транзисторы:		
T1	2Т3123	1
T2, T3	2Т396А	2
T4	2Т3123	1

Примечание. R1-R10 - исполнение напылением.

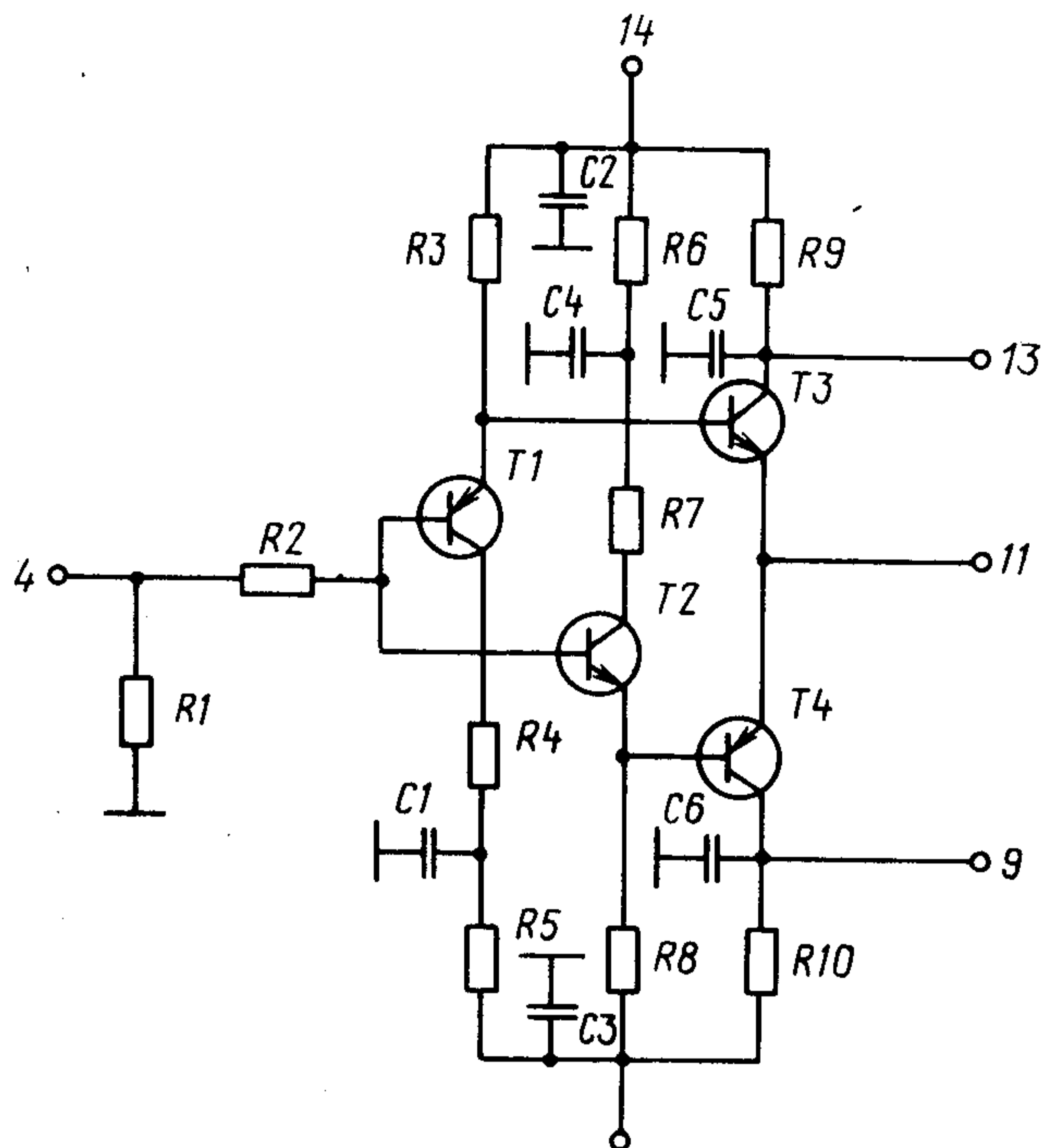


Рис.8. Схема электрическая принципиальная повторителя эмиттерного 3.426.000 ЭЗ.
Выводы 1,3,5,7,10,12 соединить с корпусом.

ДЕЛИТЕЛЬ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ

См. рис.9 на вкладке 2

Перечень элементов 5.408.009 ПЭЗ

Обозначение на рис.9	Наименование	Количество
Резисторы:		
R1, R2	ОМЛТ-0,125-5,6 кОм±10 %	2
R3	ОМЛТ-0,125-220 Ом±10 %	1
R4	ОМЛТ-0,125-47 кОм±10 %	1
R5	ОМЛТ-0,125-22 кОм±10 %	1
R6	ОМЛТ-0,125-5,6 кОм±10 %	1
R7	ОМЛТ-0,125-1 кОм±10 %	1
R8	ОМЛТ-0,125-2 кОм±5 %	1
R9	ОМЛТ-0,125-1 кОм±10 %	1
R10, R11	ОМЛТ-0,125-430 Ом±10 %	2
R12	ОМЛТ-0,125-1 кОм±10 %	1
R13	ОМЛТ-0,125-22 кОм±10 %	1
R14	ОМЛТ-0,125-430 Ом±10 %	1
R15	ОМЛТ-0,125-1 кОм±10 %	1
R16	ОМЛТ-0,125-430 Ом±10 %	1
R17	ОМЛТ-0,125-100 Ом±10 %	1
R18, R19	ОМЛТ-0,125-820 Ом±10 %	2
R20	ОМЛТ-0,125-3,9 кОм±10 %	1
R21-R24	ОМЛТ-0,125-1 кОм±10 %	4
R25	ОМЛТ-0,125-22 кОм±10 %	1
R26	ОМЛТ-0,125-6,2 кОм±5 %	1
R27	ОМЛТ-0,125-3,9 кОм±10 %	1
R28	ОМЛТ-0,125-1,0 кОм±10 %	1
R29	ОМЛТ-0,125-220 Ом±10 %	1

Обозначение на рис.9	Наименование	Количество
Конденсаторы:		
C1, C2	КМ-56-Н90-0,1 мкФ ⁺⁸⁰ / ₋₂₀ %	2
C3	К53-14-6,3 В-100 мкФ ⁺²⁰ %	1
C4	КМ-56-Н90-0,1 мкФ ⁺⁸⁰ / ₋₂₀ %	1
C5	КМ-56-М47-270 пФ±10 %	1
C6	КМ-56-Н90-0,1 мкФ ⁺⁸⁰ / ₋₂₀ %	1
C7	КМ-56-М1500-1500 пФ±20 %	1
C8-C11	КМ-56-Н90-0,1 мкФ ⁺⁸⁰ / ₋₂₀ %	4
C12	КМ-56-М47-150 пФ±10 %	1
C13	КМ-56-М1500-1000 пФ±10 %	1
C14	КМ-56-М47-100 пФ±10 %	1
C15	К53-14-10 В-47 мкФ ⁺²⁰ %	1
C16	КМ-56-Н90-0,1 мкФ ⁺⁸⁰ / ₋₂₀ %	1
C17	КМ-56-М1500-5600 пФ±10 %	1
Д1-Д5	Диод полупроводниковый 2Д510А	5
Др1	Дроссель высокочастотный ДМ-0,4-30 мкГн±5 % В	1
Микросхемы:		
МС1	564ЛА7	1
МС2	664ИЕ9	1
МС3	193ИЕ3	1
МС4	564ЛА7	1
МС5	564ЛЕ6	1
МС6	130ЛА3	1
МС7	564ТМ3	1
МС8	564ПУ4	1
МС9	564ЛА7	1
МС10	564ЛА9	1
МС11	564ЛА8	1
МС12	133ЛА3	1
МС13	133ИЕ6	1
МС14	564ТМ3	1
МС15	564ПУ4	1
МС16	133ИЕ6	1
МС17	130ЛА3	1
МС18	564ЛА7	1
МС19	564ЛА8	1
МС20	564ТМ3	1
МС21	564ЛА7	1
МС22	564Е14	1
МС23	564ТМ3	1
МС24	564ИЕ14	1
МС25	564ТМ3	1
МС26	564ИЕ14	1
МС27	564ТМ3	1
Транзисторы:		
Т1	2Т208Е	1
Т2	2Т312Б	1
Т3	2Т368А	1
Т4	2Т312Б	1
Т5	2Т368А	1
Т6	2Т208Е	1
Т7	2Т363А	1
Ш1	Разъем конструктивный	1

Перечень элементов 5.404.016 ПЭЗ

Обозначение на рис. I0 *	Наименование	Количество
	Резисторы:	
R1	ОМЛТ-0,125-2 кОм±5 %	1
R2	ОМЛТ-0,125-150 кОм±10 %	1
R3, R4	ОМЛТ-0,125-22 кОм±10 %	2
R5	ОМЛТ-0,125-5,6 кОм±10 %	1
R6, R7	ОМЛТ-0,125-150 кОм±10 %	2
R8	ОМЛТ-0,125-8,2 кОм±10 %	1
R9	ОМЛТ-0,125-100 Ом±5 %	1
R9a	ОМЛТ-0,125-120 Ом±5 %	1
R10	ОМЛТ-0,125-1 кОм±10 %	1
R11	ОМЛТ-0,125-22 кОм±10 %	1
R12	ОМЛТ-0,125-220 кОм±10 %	1
R13	ОМЛТ-0,125-22 кОм±10 %	1
R14	ОМЛТ-0,125-2 кОм±5 %	1
R15	ОМЛТ-0,125-8,2 кОм±10 %	1
R16	ОМЛТ-0,125-27 кОм±10 %	1
R17	ОМЛТ-0,125-220 кОм±10 %	1
R18	ОМЛТ-0,125-22 кОм±10 %	1
R19	ОМЛТ-0,125-27 кОм±10 %	1
R20, R21	ОМЛТ-0,125-100 Ом±10 %	2
R22	ОМЛТ-0,125-47 кОм±10 %	1
R23	ОМЛТ-0,125-330 Ом±10 %	1
R24	ОМЛТ-0,125-200 Ом±5 %	1
R24a, R24б	ОМЛТ-0,125-51 кОм±15 %	2
R25, R26	ОМЛТ-0,125-10 кОм±10 %	2
R27	ОМЛТ-0,125-3,9 кОм±10 %	1
R28	ОМЛТ-0,125-620 Ом±5 %	1
R29	ОМЛТ-0,125-27 кОм±10 %	1
R30	ОМЛТ-0,125-330 Ом±10 %	1
R31	ОМЛТ-0,125-5,1 кОм±10 %	1
R32	ОМЛТ-0,125-6,8 кОм±10 %	1
R33	ОМЛТ-0,125-5,1 кОм±10 %	1
R34	ОМЛТ-0,125-6,8 кОм±10 %	1
	Конденсаторы:	
C1	КМ-56-М47-270 пФ±5 %	1
C2	К53-14-6,3В-100 мкФ±20 % вариант I	1
C3	КМ-56-М1500-3900 пФ±10 %	1
C4	КМ-56-М47-100 пФ±5 %	1
C4a	КМ-56-Н90-0,01 мкФ±20 %	1
C5, C6	КМ-56-Н90-0,1 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	2
C7	К50-29-6,3В-22 мкФ	1
C8	К53-14-16В-22 мкФ±20 % вариант I	1
C8a	КД-1-М1500-22 пФ±5 %-3	1
C9, C10	КМ-56-Н90-0,1 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	2
C11	К50-29-63В-100 мкФ	1
C12-C16	КМ-56-Н90-0,1 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	5
C17	КМ-56-М1500-5600 пФ±10 %	1
C18-C20	КМ-56-Н90-0,1 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	3
C21	КМ-56-М47-330 пФ±5 %	1
C22, C23	КМ-56-П33-270 пФ±5 %	2
C24	КМ-56-М47-680 пФ±5 %	1

* См. рис. I0 на вкладке 3

Обозначение на рис. I0	Наименование	Количество
C25, C26	КМ-56-Н90-0,1 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	2
C27	КМ-56-Н90-0,015 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	1
C28	КМ-56-Н90-0,1 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	1
C29	КМ-56-Н90-0,068 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	1
C30	КМ-56-М1500-5600 пФ±20 %	1
ДрI	Дроссель высокочастотный ДМ-0,1-200 мкГн±5 %-В	1
Л	Катушка индуктивности ВЧ КМ-III-28 4.777.261	1
ДI	Диод полупроводниковый 2В117А	1
	Микросхемы:	
МС1	159НТ1Б	1
МС2	143КТИ	1
МС3	133ИЕ2	1
МС4	198НТ3	1
МС5	564ЛН1	1
МС6	198Н18Б	1
МС7	564ИЕ14	1
МС8	564ЛН2	1
МС9	564ЛЕ5	1
МС10	564ИЕ14	1
МС11, МС12	564ЛА7	2
МС13	564ИЕ14	1
МС14	564ТМ2	1
МС15, МС16	521СА2	2
МС17	564ИЕ14	1
МС18	143К11	1
МС19	564ПУ4	1
ПЭ1	Резонатор РГ-05-14ГС-5000 кГц-МВ-V	1
	Транзисторы:	
Т1	2Т208Е	1
Т2	2Т312Б	1
Т3	2П103А	1
Т4	2Т312Б	1
Ш1	Разъем конструктивный	1

МОДУЛЯТОР НЧ

Перечень элементов 5.081.010 ПЭЗ

Обозначение на рис. II	Наименование	Количество
	Резисторы:	
R1, R2	ОМЛТ-0,125-162 кОм±2 %	2
R3	ОМЛТ-0,125-22 кОм±10 %	1
R4	ОМЛТ-0,125-10 кОм±10 %	1
R5	ОМЛТ-0,125-3 кОм±5 %	1
R6	ОМЛТ-0,125-1,2 кОм±10 %	1
R7	ОМЛТ-0,125-22 кОм±10 %	1
R8	ОМЛТ-0,125-4,7 кОм±10 %	1
R9	ОМЛТ-0,125-10 кОм±10 %	1

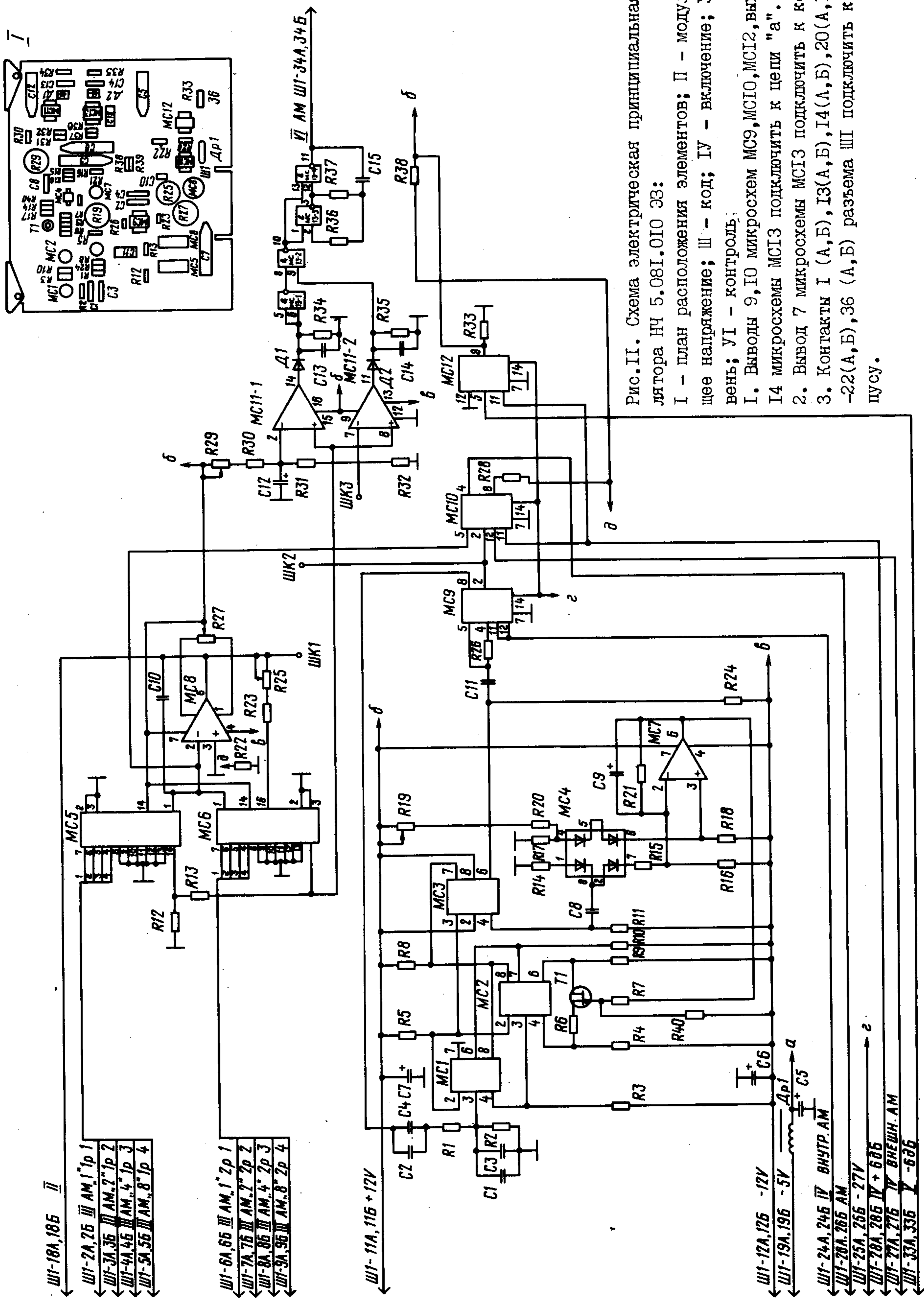


Рис. II. Схема электрическая принципиальная модулятора НЧ 5.081.010 ЭЗ:

I - план расположения элементов; II - модулирующее напряжение; III - код; IV - включение; V - управление; VI - контроль;

1. Выводы 9, 10 микросхем MC9, MC10, MC12, вывод 14 микросхемы MC13 подключить к цепи "а".

2. Вывод 7 микросхемы MC13 подключить к корпусу.

3. Контакты I (А, Б), I3(А, Б), I4(А, Б), 20(А, Б) - 22(А, Б), 36 (А, Б) разъема Ш1 подключить к корпусу.

Обозначение на рис. II	Наименование	Количество
R10	OMЛТ-0,125-22 кОм±10 %	I
R11	OMЛТ-0,125-6,8 кОм±10 %	I
R12	OMЛТ-0,125-820 Ом±5 %	I
R13	OMЛТ-0,125-8,2 кОм±5 %	I
R14, R15	OMЛТ-0,125-I кОм±10 %	2
R16	OMЛТ-0,125-220 кОм±10 %	I
R17	OMЛТ-0,125-6,8 кОм±10 %	I
R18	OMЛТ-0,125-220 кОм±10 %	I
R19	СП4-IV-22 кОм-A	I
R20	OMЛТ-0,125-22 кОм±10 %	I
R21	OMЛТ-0,125-220 кОм±10 %	I
R22	OMЛТ-0,125-47 кОм±10 %	I
R23	OMЛТ-0,125-4,7 кОм±10 %	I
R24	OMЛТ-0,125-6,8 кОм±10 %	I
R25	СП4-IV-10 кОм-A	I
R26	OMЛТ-0,125-I кОм±10 %	I
R27	СП4-IV-10 кОм-A	I
R28	OMЛТ-0,125-15 кОм±10 %	I
R29	СП4-IV-4,7 кОм-A	I
R30	OMЛТ-0,125-18 кОм±10 %	I
R31	OMЛТ-0,125-56 Ом±10 %	I
R32	OMЛТ-0,125-2,7 кОм±10 %	I
R33	OMЛТ-0,125-6,2 кОм±10 %	I
R34, R35	OMЛТ-0,125-I МОм±10 %	2
R36, R37	OMЛТ-0,125-330 кОм±10 %	2
R38	OMЛТ-0,125-68 кОм±10 %	I
R40	OMЛТ-0,125-56 кОм±10 %	I
Конденсаторы:		
C1, C2	KM-56-MI500-4700 пФ±2 %	2
C3, C4	KM-56-MI500-5600 пФ±2 %	2
C5	K50-29-6,3-100 мкФ	I
C6, C7	K50-29-I6B-100 мкФ	2
C8	KM-6B-H90-2,2 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	I
C9	K50-29-I6B-100 мкФ	I
C10	KM-56-M47-39 пФ±10 %	I
C11	KM-6B-H90-2,2 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	I
C12	K50-29-6,3B-100 мкФ	I
C13-C15	KM-56-H90-0,1 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	3
D1, D2	Диод 2Д510А	2
DrI	Дроссель высокочастотный DM-0,1-200 мкГн±5 %	I
Микросхемы.		
MC1-MC3	150HT1A	3
MC4	Диодная матрица 2ДС523ВР, дополнение 2	I
MC5, MC6	572ПА1В	2
MC7, MC8	544УД1А	2
MC9, MC10	143КТ1	2
MC11	597СА3	I
MC12	143КТ1	I
MC13	5640А7	I
TI	Транзистор 2П303Е	I
ШI	Разъем конструктивный	I

См. рис. I2 на вкладке 3

Обозначение на рис. I2	Наименование	Количество
Резисторы:		
R1-R6	OMЛТ-0,125-220 кОм±10 %	6
R7	OMЛТ-0,125-820 Ом±10 %	I
R8-R15	OMЛТ-0,125-2,2 кОм±10 %	8
R16	OMЛТ-0,125-220 кОм±10 %	I
R17	OMЛТ-0,125-820 Ом±10 %	I
R18-R24	OMЛТ-0,125-56 Ом±10 %	7
R25	OMЛТ-0,125-820 Ом±10 %	I
R26-R29	OMЛТ-0,125-2,2 кОм±10 %	4
R30	OMЛТ-0,125-820 Ом±10 %	I
R34	OMЛТ-0,125-3,9 кОм±10 %	I
R35	OMЛТ-0,125-820 Ом±10 %	I
R37	OMЛТ-0,125-620 Ом±10 %	I
R38-R41	OMЛТ-0,125-2,2 кОм±10 %	4
R42	OMЛТ-0,125-6,8 кОм±10 %	I
R43	OMЛТ-0,125-5,6 кОм±10 %	I
R44, R45	OMЛТ-0,125-22 кОм±10 %	2
R46	OMЛТ-0,125-820 Ом±10 %	I
R47-R54	OMЛТ-0,125-2,2 кОм±10 %	8
R55-R60	OMЛТ-0,125-220 кОм±10 %	6
R61	OMЛТ-0,125-4,7 кОм±10 %	I
R62	OMЛТ-0,125-I МОм±10 %	I
R63, R64	OMЛТ-0,125-270 кОм±10 %	2
R65	OMЛТ-0,125-820 Ом±10 %	I
R66-R72	OMЛТ-0,125-56 Ом±10 %	7
R73	OMЛТ-0,125-120 Ом±10 %	I
R74, R75	OMЛТ-0,125-I,2 кОм±10 %	2
R76, R77	OMЛТ-0,125-130 кОм±10 %	2
R78, R79	OMЛТ-0,125-5,6 кОм±10 %	2
R80, R81	OMЛТ-0,225-27 кОм±10 %	2
R82-R85	OMЛТ-0,125-2,2 кОм±10 %	4
R86, R87	OMЛТ-0,125-22 кОм±10 %	2
R88	OMЛТ-0,125-620 Ом±10 %	I
R89, R90	OMЛТ-0,125-10 кОм±10 %	2
R91	OMЛТ-0,125-2,7 кОм±10 %	I
R92	СП4-Ia-6,8 кОм-A-25	I
R93	OMЛТ-0,125-10 кОм±10 %	I
R94	СП4-Ia-6,8 кОм-A-25	I
R95	OMЛТ-0,125-2,2 кОм±10 %	I
R97-R100	OMЛТ-0,125-220 кОм±10 %	4
R101-R105	OMЛТ-0,125-150 кОм±10 %	5
R106	OMЛТ-0,125-100 Ом±10 %	I
R107, R108	OMЛТ-0,125-200 Ом±10 %	2
R109	OMЛТ-0,125-100 Ом±10 %	I
R110, R111	OMЛТ-0,125-200 Ом±10 %	2
R112-R114	OMЛТ-0,125-56 Ом±10 %	3
Конденсаторы:		
C1-C3	KM-56-H90-0,1 мкФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	3
C4	KM-56-M7500-1800 пФ±20 %	I
C5	K50-29-6,3 B-470 мкФ	I
C6, C7	K53-I4-I6 B-33 мкФ±20 %	2

Обозначение на рис. 12	Наименование	Количество
	вариант I	
С8, С9, С11, С12	КМ-56-Н90-0, I мкФ $^{+80}_{-20}$ %	4
С13	КМ-56-Н90-0, 015 мкФ $^{+80}_{-20}$ %	1
С14	КМ-56-Н90-0, 15 мкФ $^{+80}_{-20}$ %	1
С15	К50-29-6,3 В-470 мкФ	1
Д5-Д11	Диод 2Д104А	7
Д12-Д21	Диод светоизлучающий ЗЛ102Б	10
	Дроссели высокочастотные	
Др1	ДМ-0,6-60 мкГн \pm 5 %	1
Др2, Др3	ДМ-0,1-200 мкГн \pm 5 %	2
	Микросхемы:	
МС1	564ЛА7	1
МС2	564ИЕ9	1
МС3	ЗЛС321Б	1
МС4	514ИД1	1
МС5	564ЛН2	1
МС6	564ЛА7	1
МС7	564ТМ2	1
МС8	564ЛА7	1
МС9	ЗЛС321Б	1
МС10, МС11	149КТ1Б	2
МС12	564ТВ1	1
МС13	564ЛН2	1
МС14	ЗЛС321Б	1
МС15	564ЛН2	1
МС16	ЗЛС321Б	1
МС17	149КТ1Б	1
МС18	564ЛА7	1
МС19	564ЛН2	1
МС20	564ЛА7	1
МС21	ЗЛС321Б	1
МС23	149КТ1Б	1
МС24	ЗЛС321Б	1
МС25	564ПУ4	1
МС26	ЗЛС321Б	1
МС27	514ИД1	1
МС28-МС30	564ТМ2	3
МС31, МС32	149КТ1Б	2
МС33	ЗЛС321Б	1
МС34	564ЛЕ5	1
МС35	149КТ1Б	1
МС36	597СА3	1
МС37	564ТМ2	1
	Транзисторы:	
Т1-Т6	2Т208И	6
Т7	2Т201Г	1
Т8, Т9	2Т208И	2
Т10	2Т312Б	1
В1-В9	Переключатель кнопочный 3.603.013	9
	Датчик 5.132.001	
	Диоды:	
Д1	ЗЛ107А	1

Обозначение на рис. 12	Наименование	Количество
Д2	КФДМ	1
Д3	ЗЛ107А	1
Д4	КФДМ	1

Внимание!

В данном приборе на плате 5.174.003 могут отсутствовать МС22, Р31, Р32, Р33, Р36, С10;
- на плате 5.002.008 могут отсутствовать Р31;
- в узле 5.282.489 могут отсутствовать С6, С21, С36, L6, L21.

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ

См. рис. 13 на вкладке 4

Перечень элементов 5.139.012 ПЭЗ

Обозначение на рис. 13	Наименование	Количество
	Резисторы:	
Р1, Р2	СП3-16а-6,8 кОм \pm 20 % -2-8	2
Р3-Р11	ОМЛТ-0,125-220 Ом \pm 10 %	9
Р12	ОМЛТ-0,125-12 кОм \pm 10 %	1
Р13, Р14	ОМЛТ-0,125-56 кОм \pm 10 %	2
Р15	ОМЛТ-0,125-12 кОм \pm 10 %	1
Р16	ОМЛТ-0,125-10 кОм \pm 10 %	1
Р17	ОМЛТ-0,125-56 кОм \pm 10 %	1
Р18	ОМЛТ-0,125-15 кОм \pm 10 %	1
Р19	ОМЛТ-0,125-220 кОм \pm 10 %	1
	Конденсаторы:	
С1-С4	КМ-56-Н90-0, I мкФ $^{+80}_{-20}$ %	4
С5, С6	К53-14-16 В-33 мкФ \pm 20 %	2
	вариант I	
С6а	КМ-56-М750-1800 пФ \pm 20 %	1
С7	К53-14-30 В-22 мкФ \pm 20 %	1
	вариант I	
С8	К53-14-6,3 В-100 мкФ \pm 20 %	1
	вариант I	
С9-С13	КМ-56-Н90-0, I мкФ $^{+80}_{-20}$ %	5
С14, С15	КМ-56-М750-1800 пФ \pm 20 %	2
С16, С17	КМ-56-М1500-3300 пФ \pm 10 %	2
	Дроссели высокочастотные:	
Др1-Др3	ДМ-0,1-200 мкГн \pm 5 %	3
Др4	ДМ-0,6-60 мкГн \pm 5 %	1
	Микросхемы:	
МС1	564ИЕ10	1
МС2	564ЛА7	1
МС3, МС4	564ЛЕ5	2
МС5	564КП2	1
МС6	564МЕ14	1
МС7	134ИД3	1
МС8	564КП2	1
МС9	564МЕ14	1
МС10, МС11	564ЛА7	2
МС12	564КП2	1
МС13	564ИЕ14	1

Продолжение

Обозначение на рис. I3	Наименование	Количество
MC14	564ЛА7	I
MC15	564КП2	I
MC16	564ЛА7	I
MC17	564ИЕ14	I
MC18	564ЛА7	I
MC19	564ЛЕ6	I
MC20	564ЛА7	I
MC21	564ИЕ14	I
MC22	564ЛС2	I
MC23	564ИЕ14	I
MC24	564ИП2	I
MC25	564ЛС2	I
MC26	564ЛЕ6	I
MC27	564ПУ4	I
TI	Транзистор 2Т201Г	I
Ш1-Ш4	Розетка РЛМИ2-(I2K;2M; 2H)ГС-II (3K+IM+IH+6K+ +IM+IH+3K) В	4

ДЕШИФРАТОР ВЫХОДА

См. рис. I4 на вкладке 4

Перечень элементов 5.109.003 ПЭЭ

Обозначение на рис. I4	Наименование	Количество
RI, R2	Резисторы:	
R3	ОМЛТ-0,125-120 КОМ±10 %	2
R4-R9	ОМЛТ-0,125-1,2 КОМ±10 %	I
RI0	ОМЛТ-0,125-2,2 КОМ±10 %	6
RI1	ОМЛТ-0,125-82 КОМ±10 %	I
RI2	ОМЛТ-0,125-20 КОМ±5 %	I
RI3	ОМЛТ-0,125-47 КОМ±10 %	I
RI4-RI7	ОМЛТ-0,125-33 КОМ±10 %	I
RI8	ОМЛТ-0,125-2,2 КОМ±10 %	4
RI8a	ОМЛТ-0,125-120 КОМ±10 %	I
	ОМЛТ-0,125-5I КОМ±5 %	I

Продолжение

Обозначение на рис. I4	Наименование	Количество
RI9-R22	СПЗ-16а-6,8 КОМ±20 %-8-В	4
	Конденсаторы	
CI-C3	КМ-56-Н90-0,1 МКФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	3
C4	К53-14-6,3 В-2,2 МКФ±20 %	I
	вариант I	
C5	К53-14-16 В-33 МКФ±20 %	I
	вариант I	
C6	К53-14-30 В-22 МКФ±20 %	I
	вариант I	
C7	К53-14-6,3 В-100 МКФ±20 %	I
	вариант I	
C8	КМ-56-М47-470 ПФ±5 %	I
C9-C13	КМ-56-Н90-0,1 МКФ ⁺⁸⁰ ₋₂₀ %	5
DI, D2	Диод 2Д104А	2
Др1-Др3	Дроссель высокочастотный	
	ДМ-0,1-200 МКГн±5 %	3
	Микросхемы:	
MC1	564ЛЕ5	I
MC2, MC3	564ЛА7	2
MC4	564ЛЕ5	I
MC5, MC6	564ИЕ14	2
MC7	564КП1	I
MC8	564ЛА7	I
MC9, MC10	564ЛЕ5	2
MC11	564КП1	I
MC12, MC13	564ИЕ14	2
MC14	564ЛА7	I
MC15	564ЛЕ6	I
MC16	564ЛА7	I
MC17	564ИД1	I
MC18	564ЛЕ6	I
MC19	564ЛЕ5	I
MC20	564ЛН2	I
MC20a, MC21	564ЛА7	2
MC22	564ЛН2	I
MC23	149КТ1В	I
MC24, MC25	143КТ1	2
MC26, MC27	149КТ1В	2
Ш1	Вилка конструктивная	I

Перечень элементов 2.243.031 ПЭЭ

Обозначение на рис.15	Наименование	Количество на исполнение 2.243.031 ПЭЭ							
		-	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
В1-В20	Геркон МКА-10501	20	20	20	20	20	-20	20	20
Д1-Д10	Диод полупроводниковый 2Д103А	10	10	10	10	10	10	10	10
Ш1	Розетка 3.640.006 Розетка 3.640.009 Вилка кабельная СР-50-IIIФ Вилка 3.640.289	I	I	I		I		I	I
Ш2	Розетки 3.640.006 3.640.009 3.647.040	I	I	I		I	I	I	I
Ш3	Вилка РПИ5-15ШВ Вилка РЛМИ2 (12К;3Л;2М;2Н) Шс-Оп (1Н+1Н+1Л+12К+12Л+ 1М+1Н)	I	I	I	I	I		I	I
ЭМ1-ЭМ5	Электромагниты 3.254.006 3.254.006-01 3.254.006-02 3.254.006-04	I	I	I	I	I		I	I
	<u>Секция ослабления Э1</u> Резисторы								
Р1	С2-10-0,25-51,1 Ом±0,5 %-В					I			
	С2-10-0,25-102 Ом±0,5 %-В			I	I				
Р2	С2-10-0,25-221 Ом±0,5 %-В С2-10-0,25-23,7 Ом±0,5 %-В С2-10-0,25-102 Ом±0,5 %-В С2-10-0,25-2,49 кОм±0,5 %-В	I	I						
	С2-10-0,25-23,7 Ом±0,5 %-В			I	I		I	I	I
Р3	С2-10-0,25-51,1 Ом±0,5 %-В С2-10-0,25-221 Ом±0,5 %-В С2-10-0,5-2,49 кОм±0,5 %-В	I	I						
Р4	С2-10-0,25-102 Ом±0,5 %-В			I	I		I	I	I
Р5	С2-10-0,25-102 Ом±0,5 %-В			I	I		I	I	I
	<u>Секция ослабления Э2</u> Резисторы:								
Р1	С2-10-0,25-96,5 Ом±0,5 %-В С2-10-0,25-866 Ом±0,5 %-В			I	I	I	I	I	
Р2	С2-10-0,25-5,76 Ом±0,5 %-В С2-10-0,25-71,5 Ом±0,5 %-В	I	I						I
Р3	С2-10-0,25-96,5 Ом±0,5 %-В С2-10-0,25-866 Ом±0,5 %-В	I	I			I	I	I	I
	<u>Секция ослабления Э3</u> Резисторы:								
Р1	С2-10-0,25-51,1 Ом±0,5 %-В С2-10-0,25-102 Ом±0,5 %-В С2-10-0,25-117 Ом±0,5 %-В С2-10-0,25-178 Ом±0,5 %-В С2-10-0,25-211 Ом±0,5 %-В					I		I	
Р2	С2-10-0,25-30,5 Ом±0,5 %-В С2-10-0,25-53 Ом±0,5 %-В С2-10-0,25-102 Ом±0,5 %-В С2-10-0,25-2,49 кОм±0,5 %-В С2-10-0,25-23,7 Ом±0,5 %-В			I	I			I	I

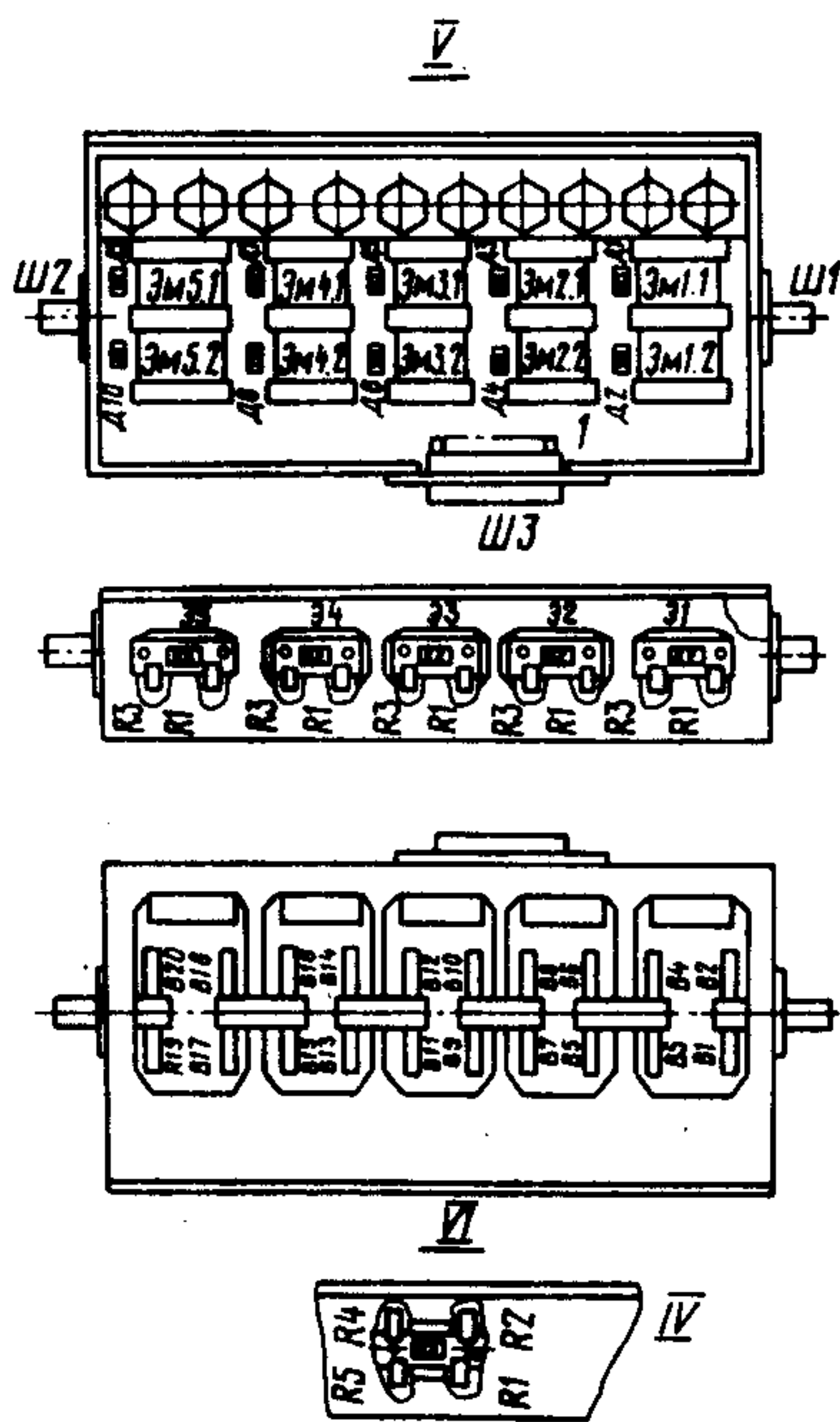
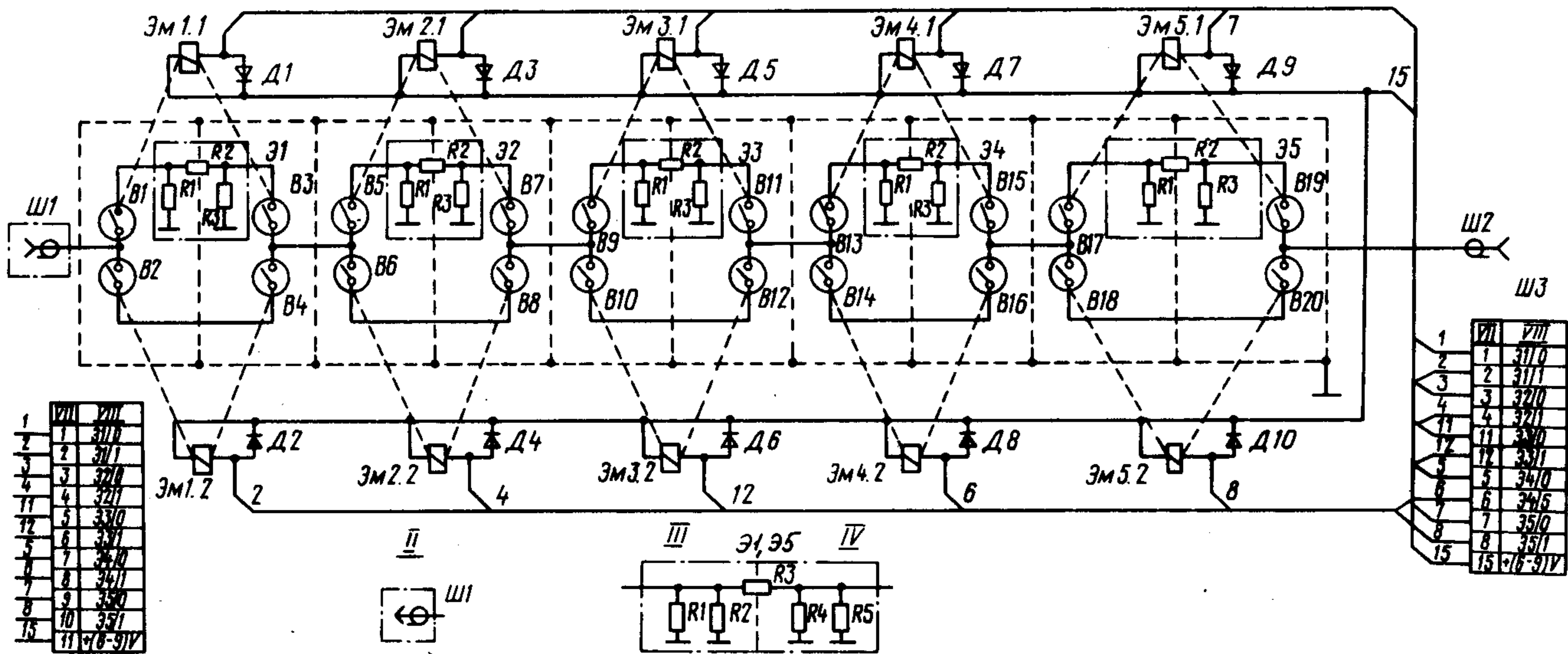


Рис.15. Схема электрическая принципиальная аттенуатора 2.243.03I ЭЗ:

I - рис.1; II - рис.2, остальное см.рис.1; III - рис.3; остальное см.рис.1; IV - Э (см.табл.); V - рис.4; VI - рис.5, остальное см.рис.1; VII - контакт; VIII - цепь

1. Все секции ослабления (Э) включены на ослабление сигнала.
2. Уровень "0" соответствует управляющему постоянному току от 45 мА до 60 мА.
3. Уровень "I" соответствует управляющему постоянному току не более 3 мА.
4. Рабочая величина управляющего напряжения должна быть $(7,5 \pm 1,5) \text{ V}$, напряжение срабатывания для герконов должно быть не более 6 В.

Обозначение (рис. 15)	III	Секция ослабления										III
		Э1		Э2		Э3		Э4		Э5		
		Рисунок	Ослабление, дБ	Рисунок	Ослабление, дБ	Рисунок	Ослабление, дБ	Рисунок	Ослабление, дБ	Рисунок	Ослабление, дБ	
2.243.03I ЭЗ	I	I;4	4	I;4	I	I;4	8	I;4	2	I;4	40	I
-01 ЭЗ	I	I;4	4	I;4	I	I;4	8	I;4	2	3;5	40	I
-02 ЭЗ	I	3;5	40	I;4	10	I;4	5	I;4	20	3;5	40	I
-03 ЭЗ	2	3;5	40	I;4	10	I;4	5	I;4	20	3;5	40	I
-04 ЭЗ	I	I;4	40	I;4	10	I;4	40	I;4	20	I;4	40	I
-05 ЭЗ	I	3;5	40	I;4	10	3;5	40	I;4	20	3;5	40	6
-06 ЭЗ	I	3;5	40	I;4	10	3;5	40	I;4	20	3;5	40	6
-07 ЭЗ	I	3;5	40	I;4	I	I;4	4	I;4	2	3;5	40	

Обозначение на рис. I5	Наименование	Количество на исполнение 2.243.03I ПЭЗ							
		-	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
R3	C2-10-0,25-5I,I Ом±0,5 %-B					I			
	C2-10-0,25-II7 Ом±0,5 %-B	I	I						
	C2-10-0,5-2,49 кОм±0,5 %-B						I	I	
	C2-10-0,25-I78 Ом±0,5 %-B			I	I				
	C2-10-0,25-22I Ом±0,5 %-B								I
R4	C2-10-0,25-I02 Ом±0,5 %-B						I	I	
R5	C2-10-0,25-I02 Ом±0,5 %-B						I	I	
	<u>Секция ослабления Э4</u>								
	Резисторы:								
R1	C2-10-0,25-6I,2 Ом±0,5 %-B			I	I	I	I	I	
	C2-10-0,25-437 Ом±0,5 %-B	I	I						I
R4	C2-10-0,25-I02 Ом±0,5 %-B						I	I	
R5	C2-10-0,25-I02 Ом±0,5 %-B						I	I	
R2	C2-10-0,25-II,7 Ом±0,5 %-B	I	I						I
	C2-10-0,25-249 Ом±0,5 %-B			I	I	I	I	I	
R3	C2-10-0,25-6I,2 Ом±0,5 %-B			I	I	I	I	I	
	C2-10-0,25-437 Ом±0,5 %-B	I	I						I
	<u>Секция ослабления Э5</u>								
	Резисторы:								
R1	C2-10-0,25-5I,I Ом±0,5 %-B	I					I		
	C2-10-0,25-I02 Ом±0,5 %-B		I	I	I		I	I	I
R2	C2-10-0,25-I02 Ом±0,5 %-B		I	I	I		I	I	I
	C2-10-0,25-2,49 кОм±0,5 %-B						I		
	C2-10-0,5-2,49 кОм±0,5 %-B	I							
R3	C2-10-0,25-5I,I Ом±0,5 %-B	I					I		
	C2-10-0,5-2,49 кОм±0,5 %-B		I	I	I		I	I	I
R4	C2-10-0,25-I02 Ом±0,5 %-B		I	I	I		I	I	I
R5	C2-10-0,25-I02 Ом±0,5 %-B		I	I	I		I	I	I

БЛОК ПИТАНИЯ
Перечень элементов 2.087.034 ПЭЗ

Обозначение на рис. I6	Наименование	Коли- чест- во
В1	Тумблер ТЗ	1
Д1-Д4	Диод 2Д202В	4
Ш1	Счетчик ЭСВ-2,5-12,6	1
Кл1	Клемма К4-1,8	1
Пр1, Пр2	Вставка плавкая ВП2Б-1В 2,0 А 250 В	2
Т1-Т4	Транзистор 2Т808А	4
Тр1	Трансформатор 4.705.05I	1

Обозначение на рис. I6	Наименование	Коли- чест- во
Ш3	* Розетка РП10-7	1
Ш4	Вилка 3.645.305	1
Ш5, Ш6	Розетка РП10-II	2
У1	Выпрямитель 5.121.007	1
У2	Усилитель стабилизатора 5.123.006	1
Р1, Р2	Резисторы ОМЛТ-2-36 Ом±5 %	2
	<u>Плата объединительная</u> 5.282.512	
Ш1, Ш2	Розетка СШП4-72/120Х10Р- -19-В	2

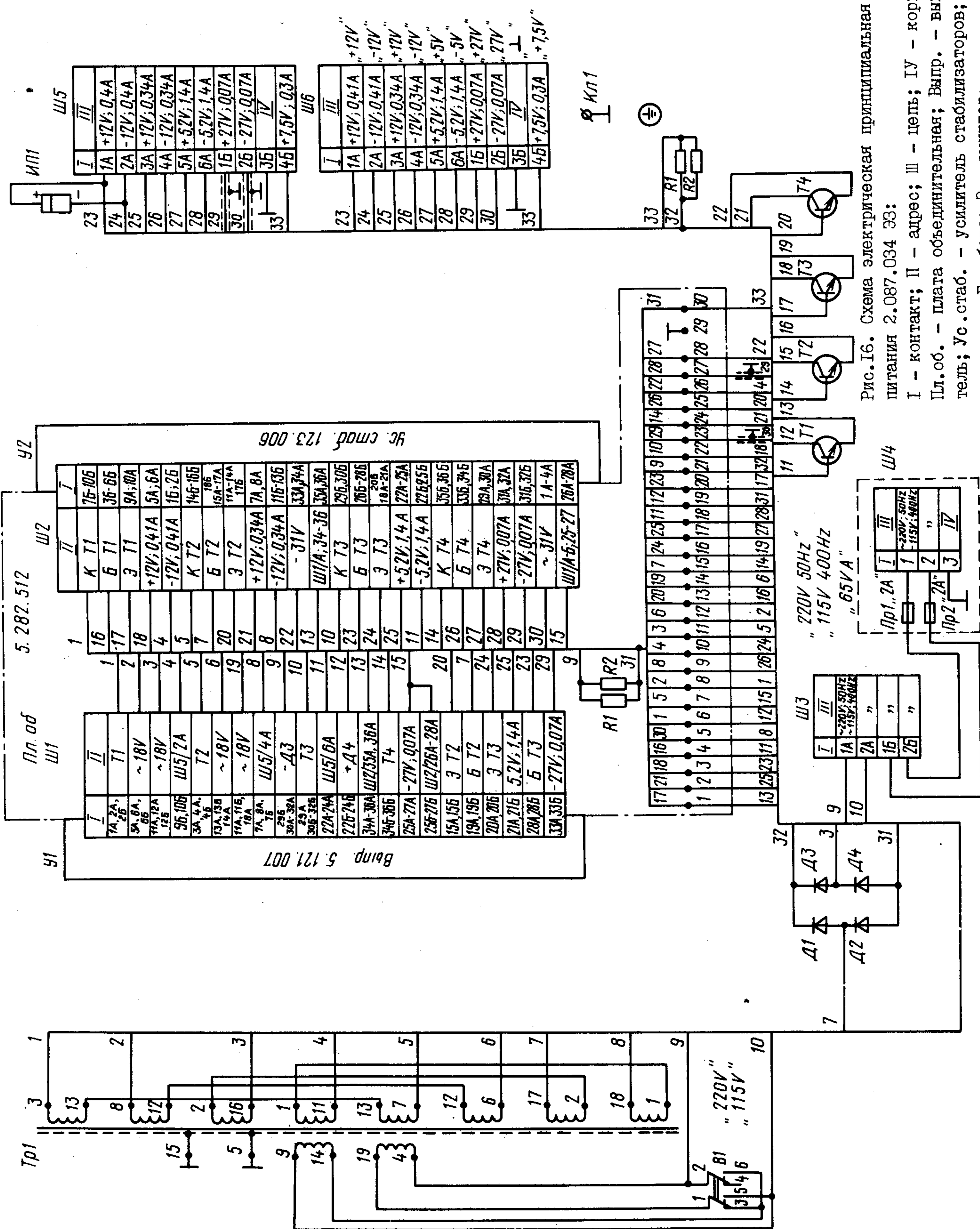


Рис.16. Схема электрическая принципиальная блока питания 2.087.034 ЭЗ:
 I - контакт; II - адрес; III - цепь; IV - корпус
 Пл.об. - плата объединительная; Выпр. - выпрямитель; Ус.стаб. - усилитель стабилизаторов; К - коллектор; Б - база; Э - эмиттер

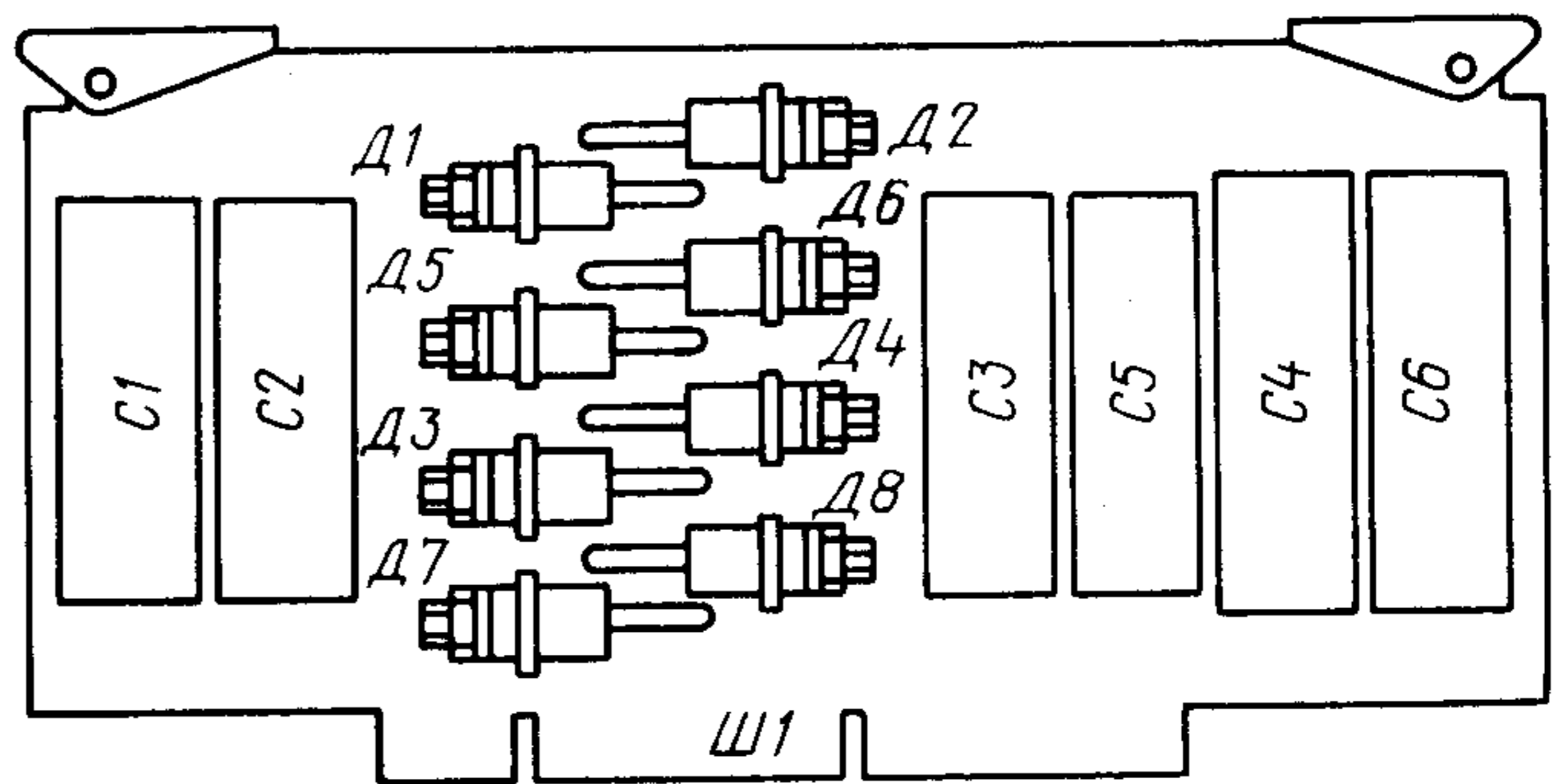
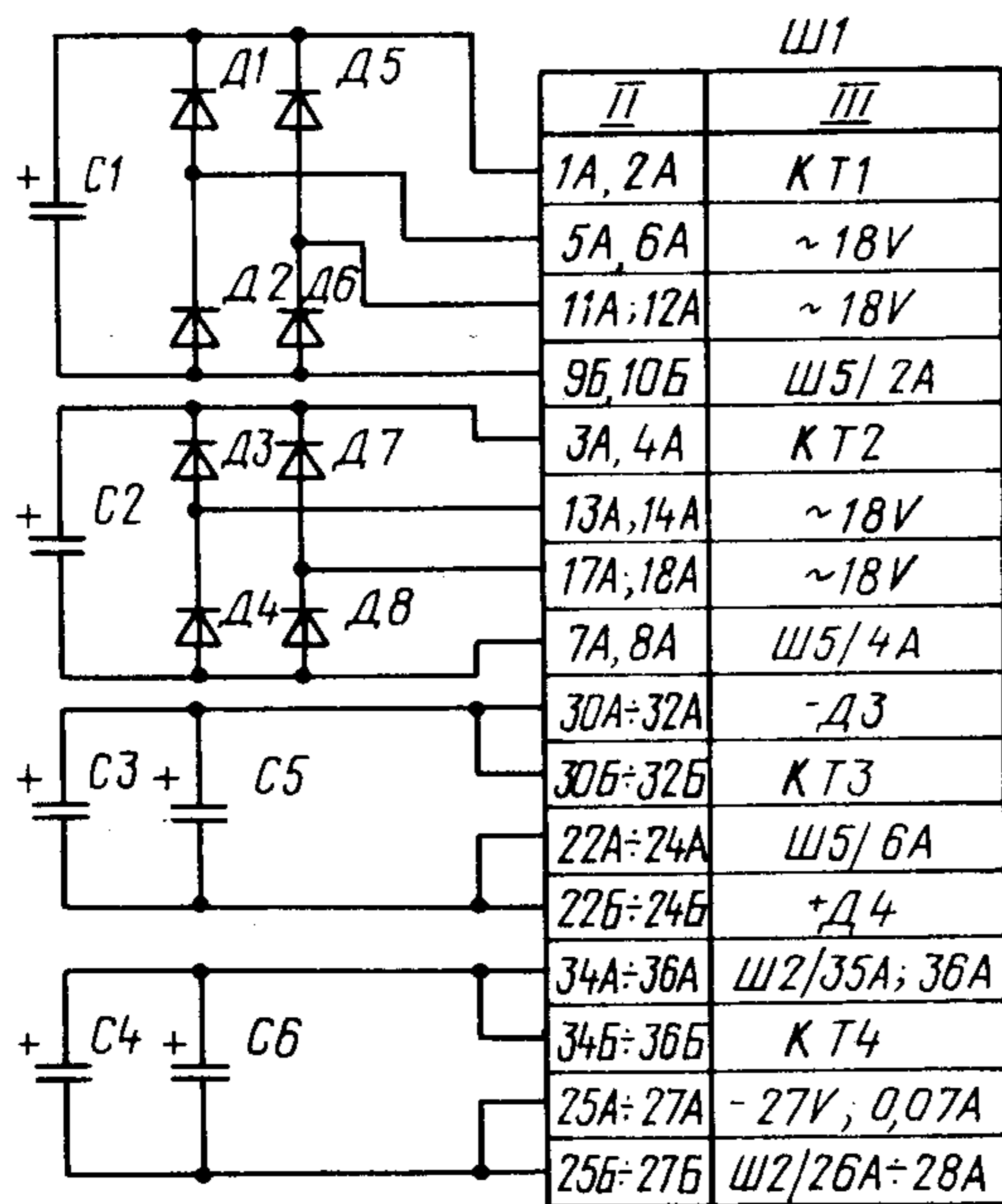


Рис.17. Схема электрическая принципиальная выпрямителя 5.121.007 ЭЗ:
 I - план расположения элементов; II - контакт;
 III - цепь; К - коллектор

ВЫПРЯМИТЕЛЬ
 Перечень элементов 5.121.007 ПЭЗ

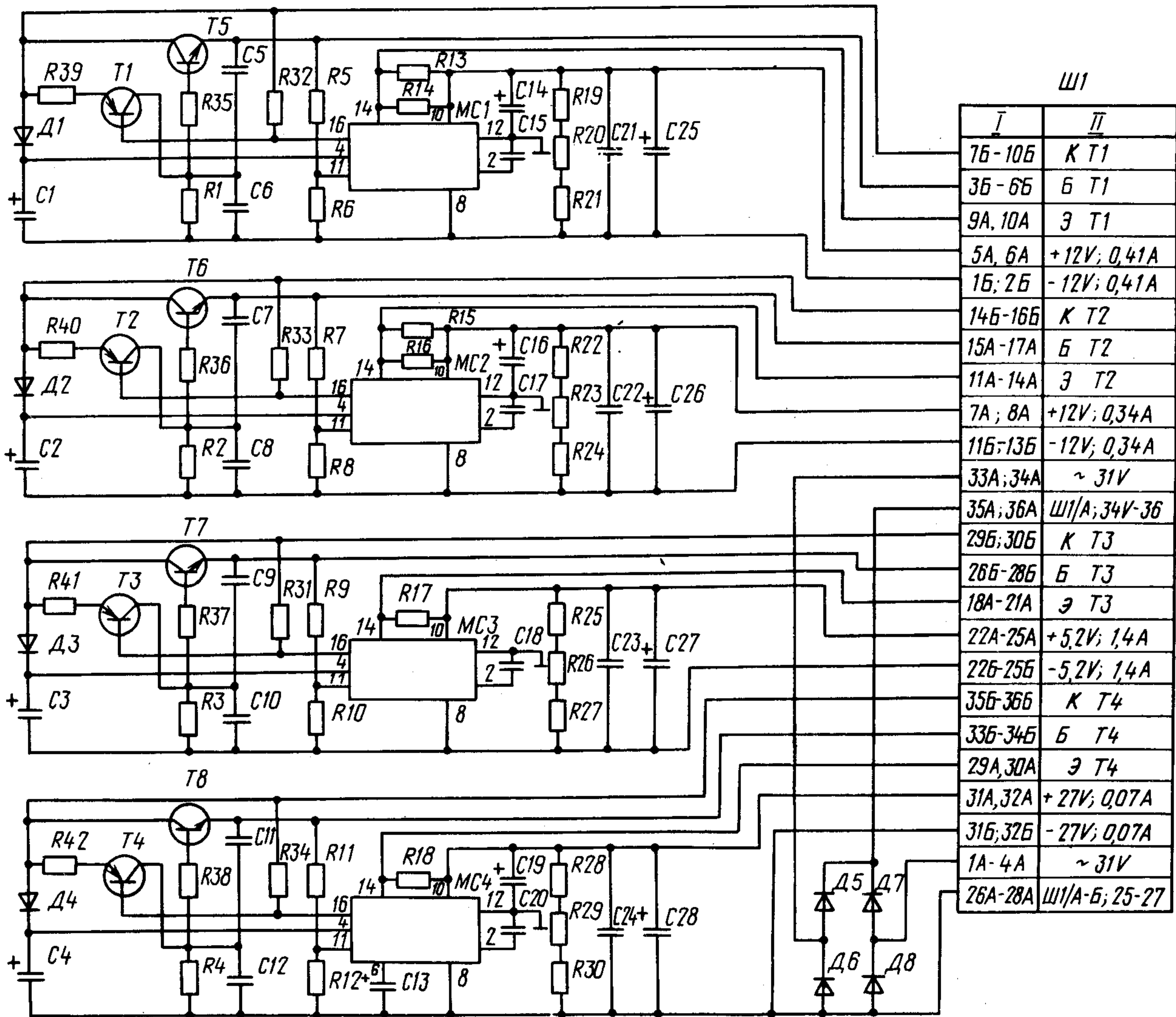
Обозначение на рис.17	Наименование	Количество
Конденсаторы:		
C1-C3	K50-29-25 В-2200 мкФ	3
C4	K50-29-63 В-1000 мкФ	1
C5	K50-29-25 В-2200 мкФ	1
C6	K50-29-63 В-1000 мкФ	1
Д1-Д8	Диод 2Д202В	8
Ш1	Вилка конструктивная	1

СТАБИЛИЗАТОР
 Перечень элементов 5.126.006 ПЭЗ

Обозначение на рис.18	Наименование	Количество
Резисторы:		
R1-R4	ОМЛТ-0,25-27 кОм±10%	4
R5	ОМЛТ-0,25-1 кОм±5%	1
R6	ОМЛТ-0,25-9,1 кОм±5%	1
R7	ОМЛТ-0,25-1 кОм±5%	1
R8	ОМЛТ-0,25-9,1 кОм±5%	1
R9	ОМЛТ-0,25-120 Ом±5%	1
R10	ОМЛТ-0,25-1,2 кОм±5%	1
R11	ОМЛТ-0,25-1 кОм±5%	1
R12	ОМЛТ-0,25-9,1 кОм±5%	1
R13-R16	C2-10-0,5-1 Ом±1%-В	4
R17	C5-16В-1 Вт-0,15 Ом±1%	1
R18	C2-10-0,5-2 Ом±1%-В	1
R19	ОМЛТ-0,25-6,8 кОм±5%	1
R20	СП4-1В-3,3 кОм-А	1
R21	ОМЛТ-0,25-680 Ом±5%	1
R22	ОМЛТ-0,25-6,8 кОм±5%	1
R23	СП4-1В-3,3 кОм-А	1

Продолжение

Обозначение на рис.18	Наименование	Количество
R24	ОМЛТ-0,25-680 Ом±5%	1
R25	ОМЛТ-0,25-2,2 кОм±5%	1
R26	СП4-1В-3,3 кОм-А	1
R27	ОМЛТ-0,25-1,1 кОм±5%	1
R28	ОМЛТ-0,25-6,8 кОм±5%	1
R29	СП4-1В-3,3 кОм-А	1
R30	ОМЛТ-0,25-680 Ом±5%	1
R31	ОМЛТ-0,125-320 Ом±10%	1
R32, R33	ОМЛТ-0,125-1,2 кОм±10%	2
R34	ОМЛТ-0,125-2,7 кОм±10%	1
R35-R38	ОМЛТ-0,25-330 Ом±5%	4
R39-R42	ОМЛТ-0,125-300 Ом±5%	4
Конденсаторы:		
C1-C3	K50-29-25 В-47 мкФ	3
C4	K50-29-63 В-220 мкФ	1
C5, C7, C9, C11	КМ-56-Н90-0,047 мкФ ⁺⁸⁰ / ₋₂₀ %	4
C6, C8, C10, C12	КМ-56-Н90-0,047 мкФ ⁺⁸⁰ / ₋₂₀ %	4
C13	K53-14-6,3 В-47 мкФ ₋₂₀ %	1
C14	K53-14-16В-4,7 мкФ ₋₂₀ %	1
C15	КМ-56-Н90-0,047 мкФ ⁺⁸⁰ / ₋₂₀ %	1
C16	K53-14-16-В-4,7 мкФ ₋₂₀ %	1
C17, C18	КМ-56-Н90-0,047 мкФ ⁺⁸⁰ / ₋₂₀ %	2
C19	K53-14-30 В-4,7 мкФ ₋₂₀ %	1
C20-C24	КМ-56-Н90-0,047 мкФ ⁺⁸⁰ / ₋₂₀ %	5
C25-C28	K53-14-30В-10 мкФ ₋₂₀ %	4
Диоды:		
Д1-Д4	2Д102А	4
Д5-Д8	Д237А	4
Транзисторы:		
Т1-Т4	2Т203А	4
Т5-Т8	2Т608А	4
Микросхемы:		
МС1-МС3	142ЕН1Б	3
МС4	142ЕН2Б	1
Ш1	Вилка конструктивная	1



Ш1	
I	II
7Б-10Б	К Т1
3Б-6Б	Б Т1
9А, 10А	Э Т1
5А, 6А	+12V; 0,41А
1Б; 2Б	-12V; 0,41А
14Б-16Б	К Т2
15А-17А	Б Т2
11А-14А	Э Т2
7А; 8А	+12V; 0,34А
11Б; 13Б	-12V; 0,34А
33А; 34А	~ 31V
35А; 36А	Ш1/А; 34V-36
29Б; 30Б	К Т3
26Б-28Б	Б Т3
18А-21А	Э Т3
22А-25А	+5,2V; 1,4А
22Б-25Б	-5,2V; 1,4А
35Б-36Б	К Т4
33Б-34Б	Б Т4
29А, 30А	Э Т4
31А, 32А	+27V; 0,07А
31Б; 32Б	-27V; 0,07А
1А-4А	~ 31V
26А-28А	Ш1/А-Б; 25-27

Рис.18. Схема электрическая принципиальная стабилизатора 5.I23.006 ЭЗ:

I - контакт; II - цепь; К - коллектор; Б - база; Э - эмиттер

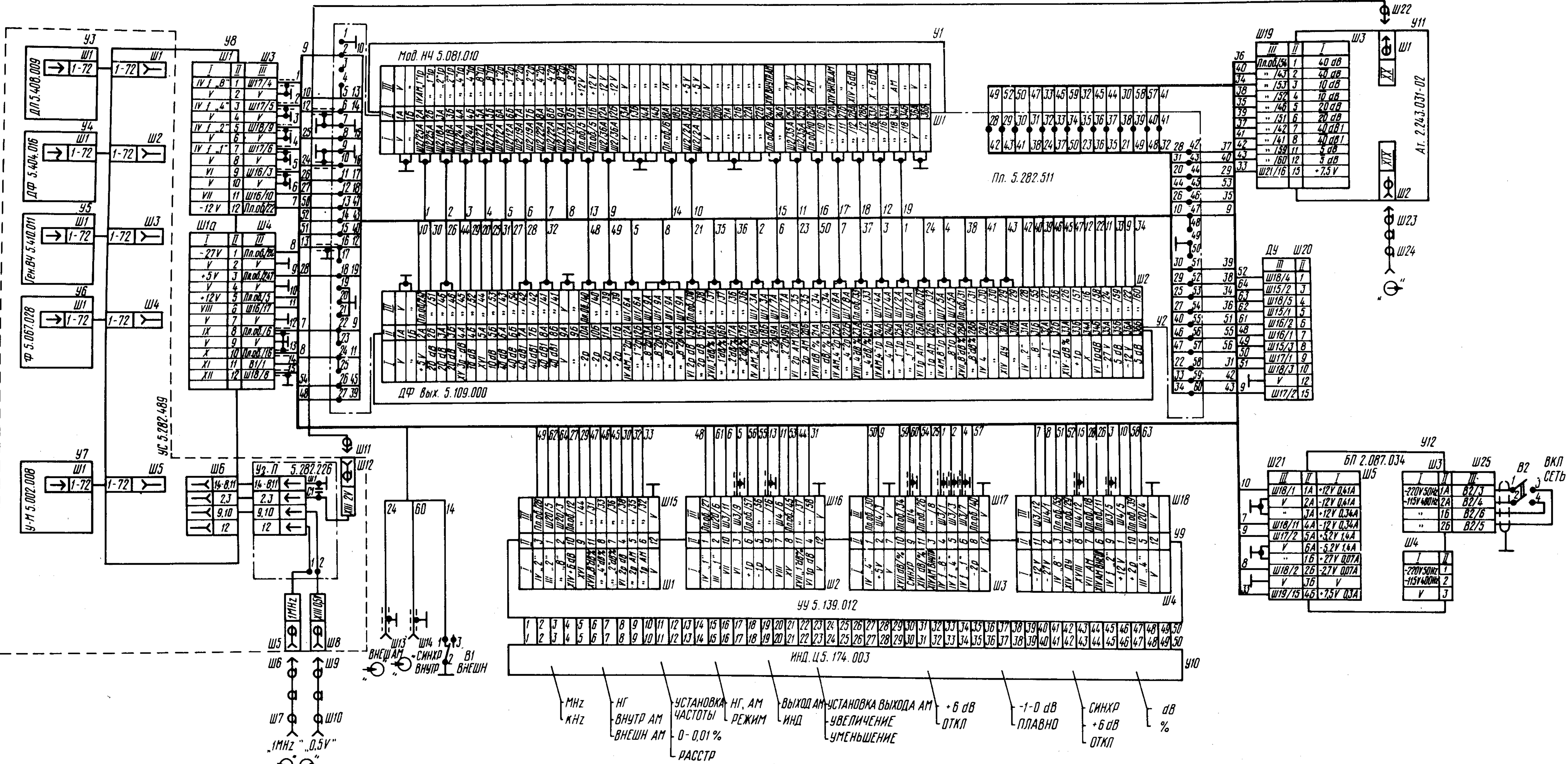


Рис.1. Схема электрическая принципиальная генератора сигналов высокочастотного 3.260.018 ЭЗ:
 I - цепь; II - контакт; III - адрес; IV - код; V - корпус; VI - нагрузка; VII - контроль; VIII - контроль синхронизации; IX - модулирующее напряжение; X - уровень; XI - включение кварца; XII - перестройка; XIII - выход; XIV - включение; XV - индикация; XVI - отключение вы-

хода; XVII - стробирование.
 ДП - делитель программируемый; ДФ - дешифратор; Ген.ВЧ - генератор ВЧ; Ф - фильтр; У-М - усилитель-модулятор; УС - устройство соединительное; УзП - узел печатный; Мод.НЧ - модулятор низкой частоты; ДФвых. - дешифратор выхода; Пл - плата; Ат - аттенюатор; БП - блок питания

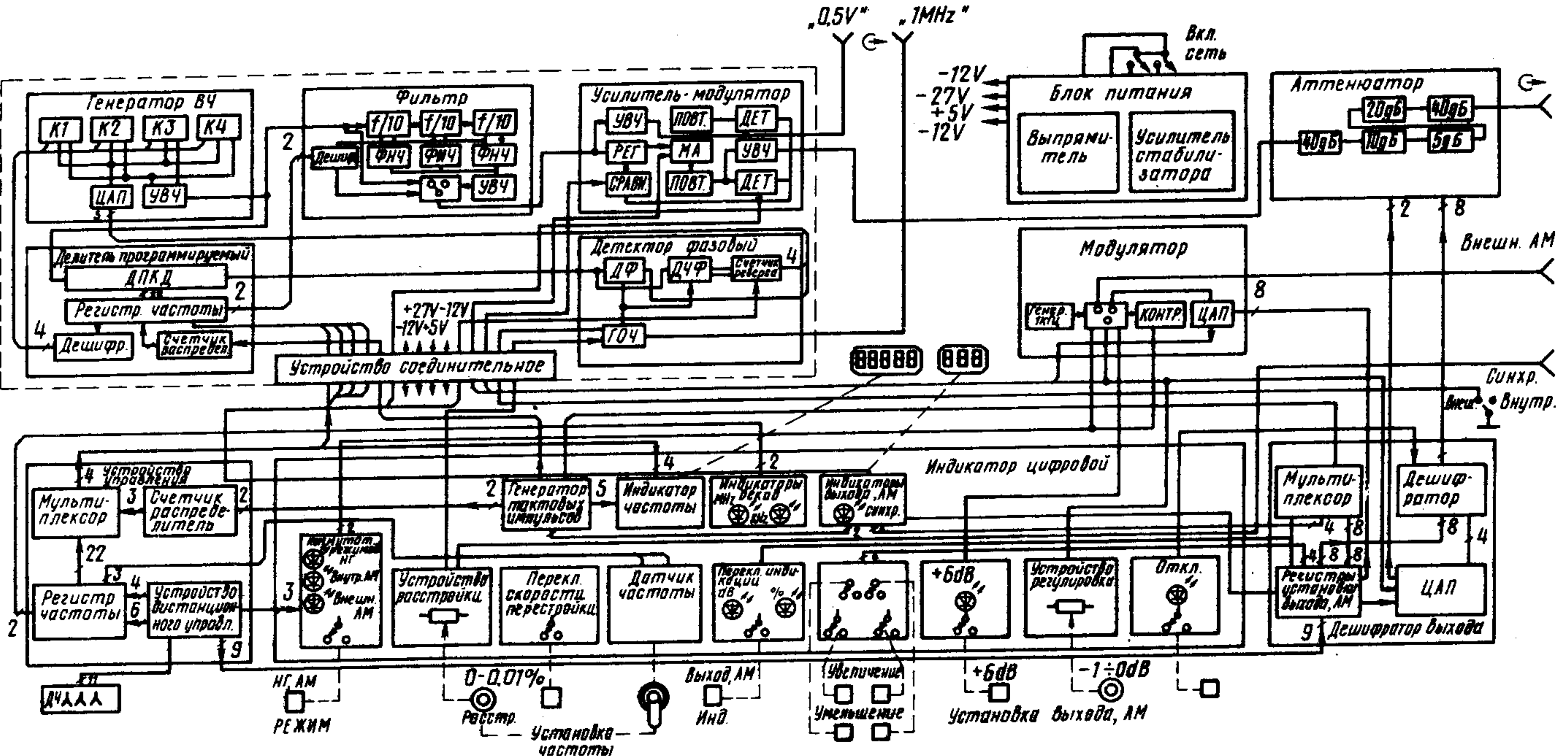


Рис.2. Схема структурная генератора Г4-158

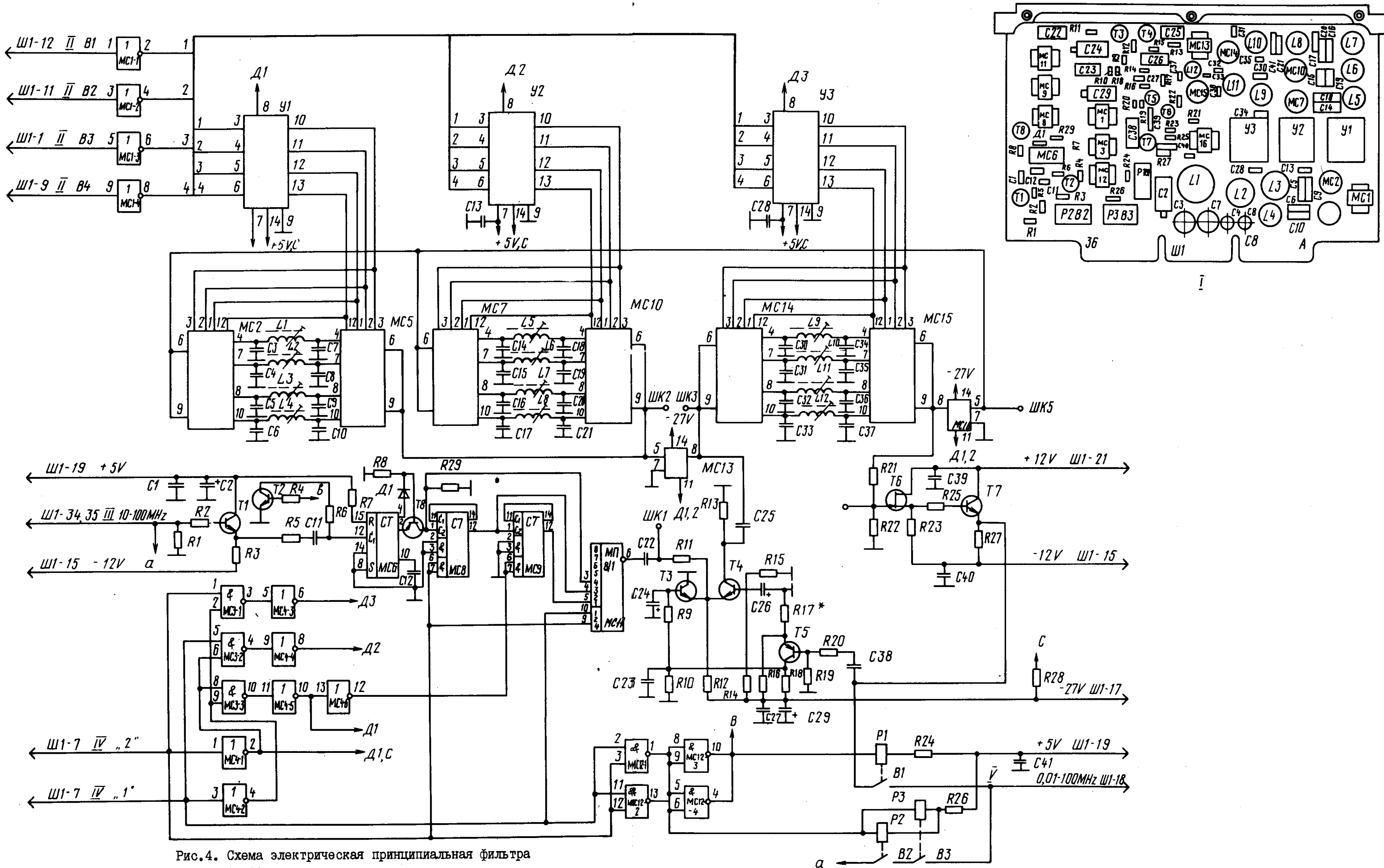


Рис.4. Схема электрическая принципиальная фильтра

5.067.028 ЭЗ:

I - план расположения элементов; II - включение;

III - вход; IV - код; V - выход

1. Вывод 7 микросхем MC1, MC3, MC4, MC12, выводы I, 2, 7, 8, II-13 - микросхемы MC11, вывод 10 микросхем MC8, MC9 подсоединить к корпусу.

2. Вывод 14 микросхем MC1, MC3, MC4, MC11, MC12, вывод 5 микросхем MC2, MC5, MC7-MC10, MC14, MC15, вывод 16 микросхемы MC6, выводы 9, 10 микросхем MC13, MC16 подсоединить к шине +5V.

3. Контакты I, 3-9, II, 12, 14, 16-18, 20, 22, 24 III подсоединить к корпусу.

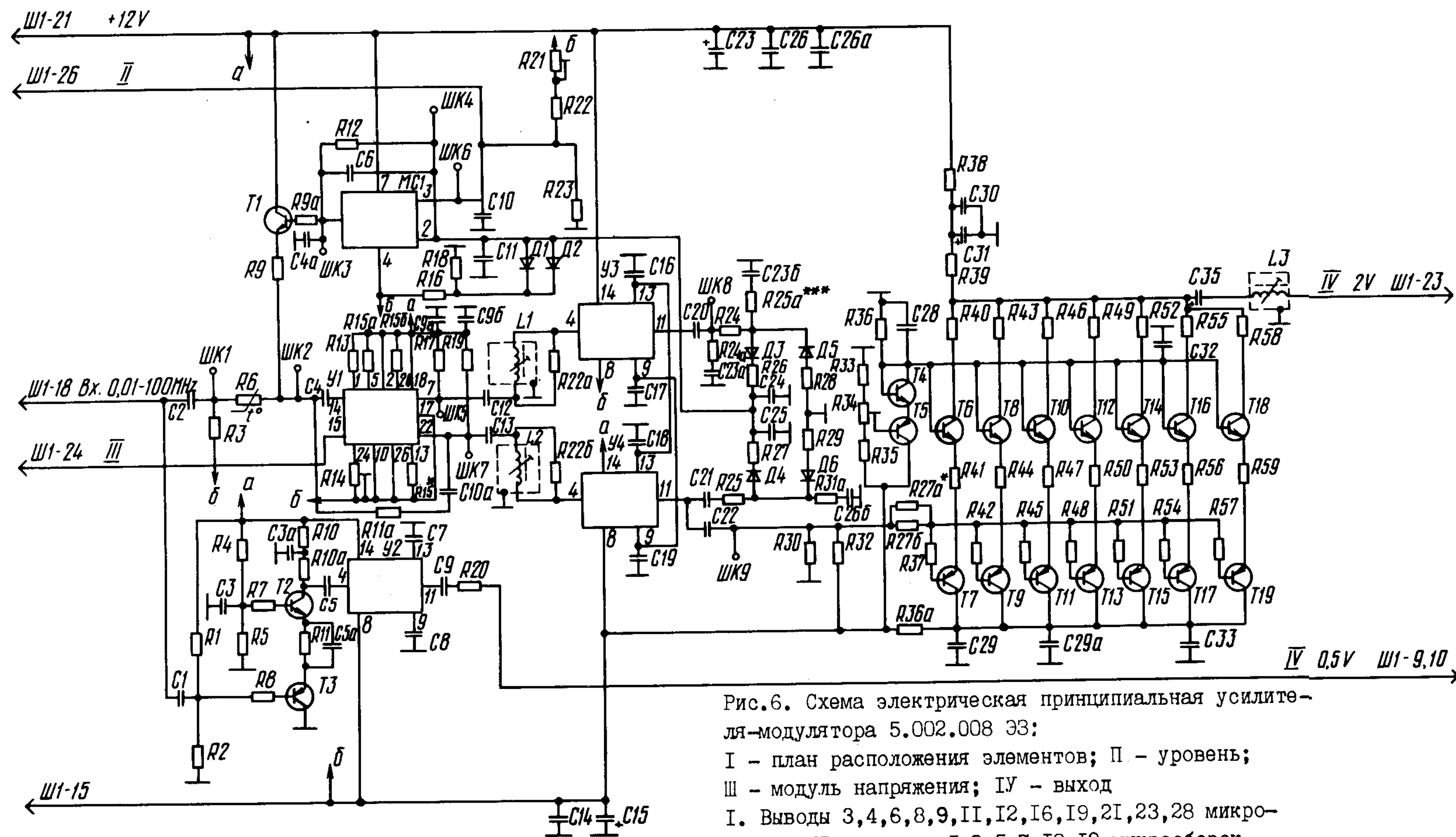
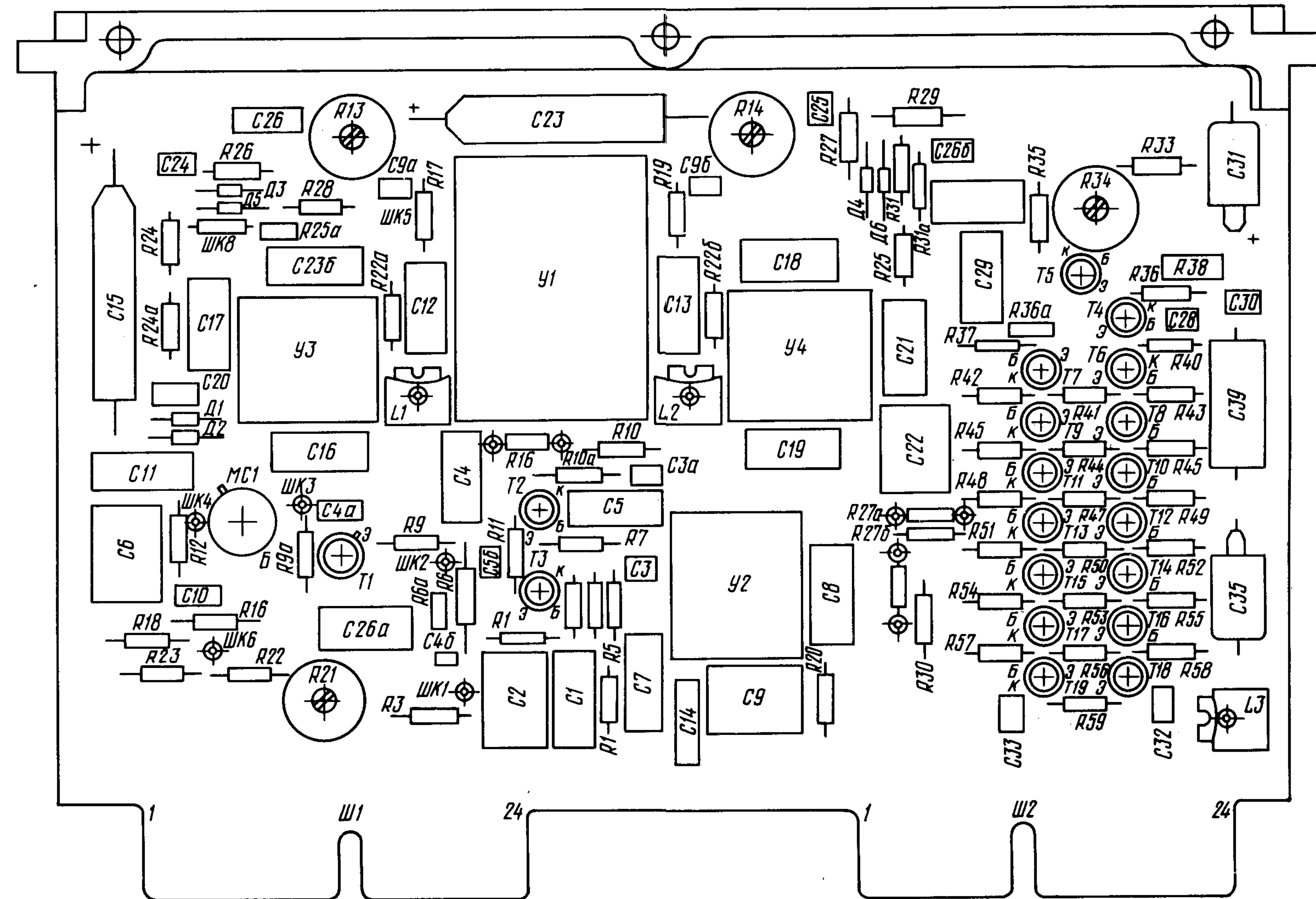


Рис.6. Схема электрическая принципиальная усилителя-модулятора 5.002.008 ЭЗ:
 I - план расположения элементов; II - уровень;
 III - модуль напряжения; IV - выход
 1. Выводы 3,4,6,8,9,11,12,16,19,21,23,28 микросборки У1 и выводы 1,3,5,7,10,12 микросборок У2,У3,У4 соединить с корпусом.
 2. Контакты I,4-8, II-13, 16,17,22,23,25,27, 29-36 разъема III соединить с корпусом.



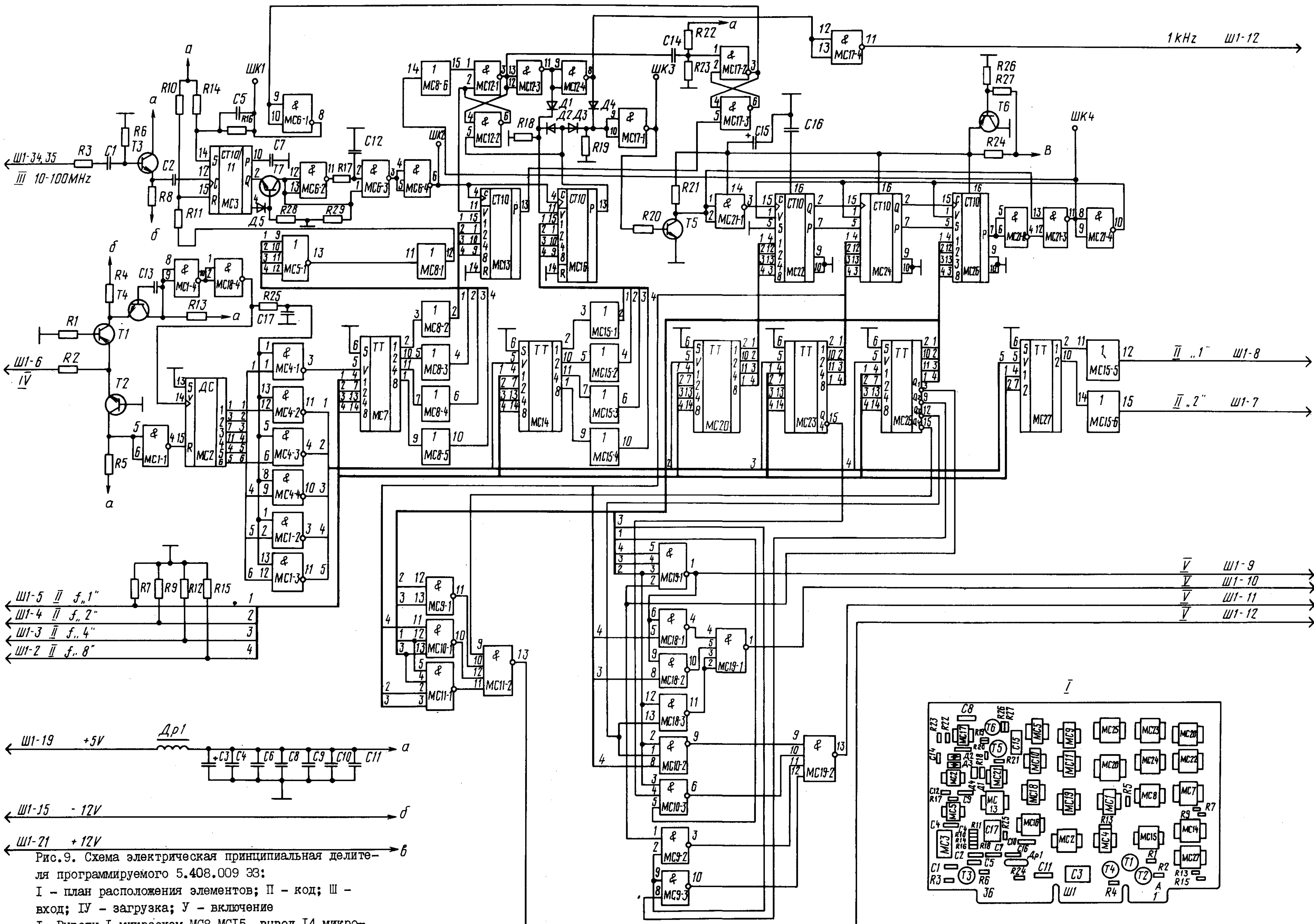


Рис.9. Схема электрическая принципиальная делителя программируемого 5.408.009 ЭЗ:
 I - план расположения элементов; II - код; III - вход; IV - загрузка; V - включение
 1. Выводы I микросхем MC8, MC15, вывод I4 микросхем MC1, MC4-MC6, MC9-MC12, MC17, MC19, вывод I6 микросхем MC2, MC3, MC7, MC13, MC14, MC16, MC20, MC23, MC25, MC27 подключить к цепи "а":
 2. Вывод 7 микросхем MC1, MC4, MC5, MC6, MC9-MC19, MC21, вывод 8 микросхем MC2, MC3, MC7, MC8, MC13-MC16, MC20, MC22-MC27 подключить к корпусу.
 3. Контакты I, I3, I6, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 36 разъема III подключить к корпусу.

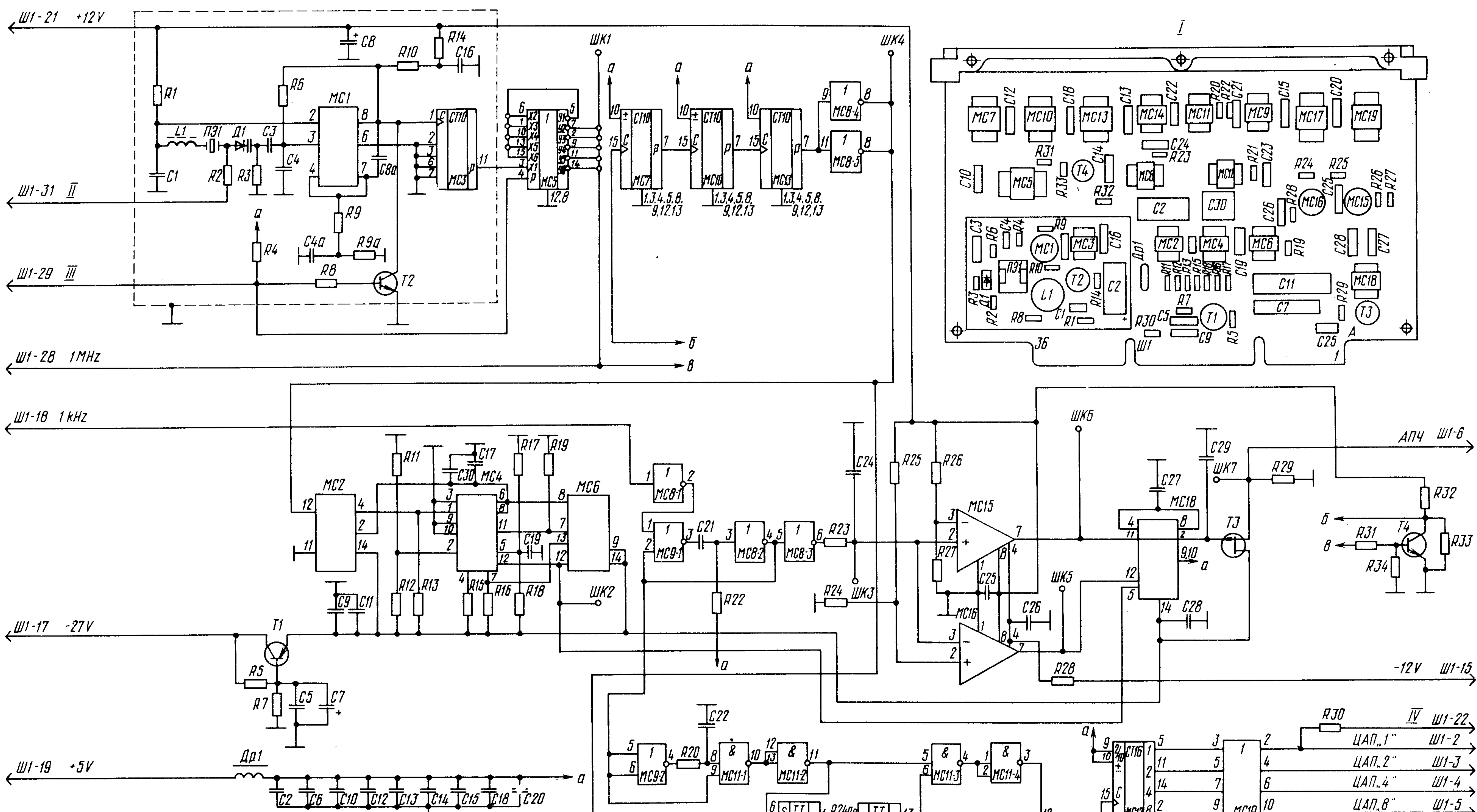


Рис.10. Схема электрическая принципиальная детектора фазового 5.404.016 93:
 I - план расположения элементов; II - перестройка;
 III - включение кварца; IV - контроль синхронизации
 1. Вывод 5 микросхемы MC3, выходы 9,10 микросхемы MC2, вывод 14 микросхем MC8, MC9, MC11, MC12, MC14, вывод 16 микросхем MC5, MC7, MC10, MC13, MC17, вывод 1 микросхемы MC19 подключить к цепи "а".
 2. Вывод 10 микросхемы MC3, вывод 7 микросхем MC2, MC8, MC9, MC11, MC12, MC14, MC18, вывод 8 микросхемы MC19 подключить к корпусу.
 3. Контакты 1,13,16,23,25,27,30,32,33,36 разъема III подключить к корпусу.

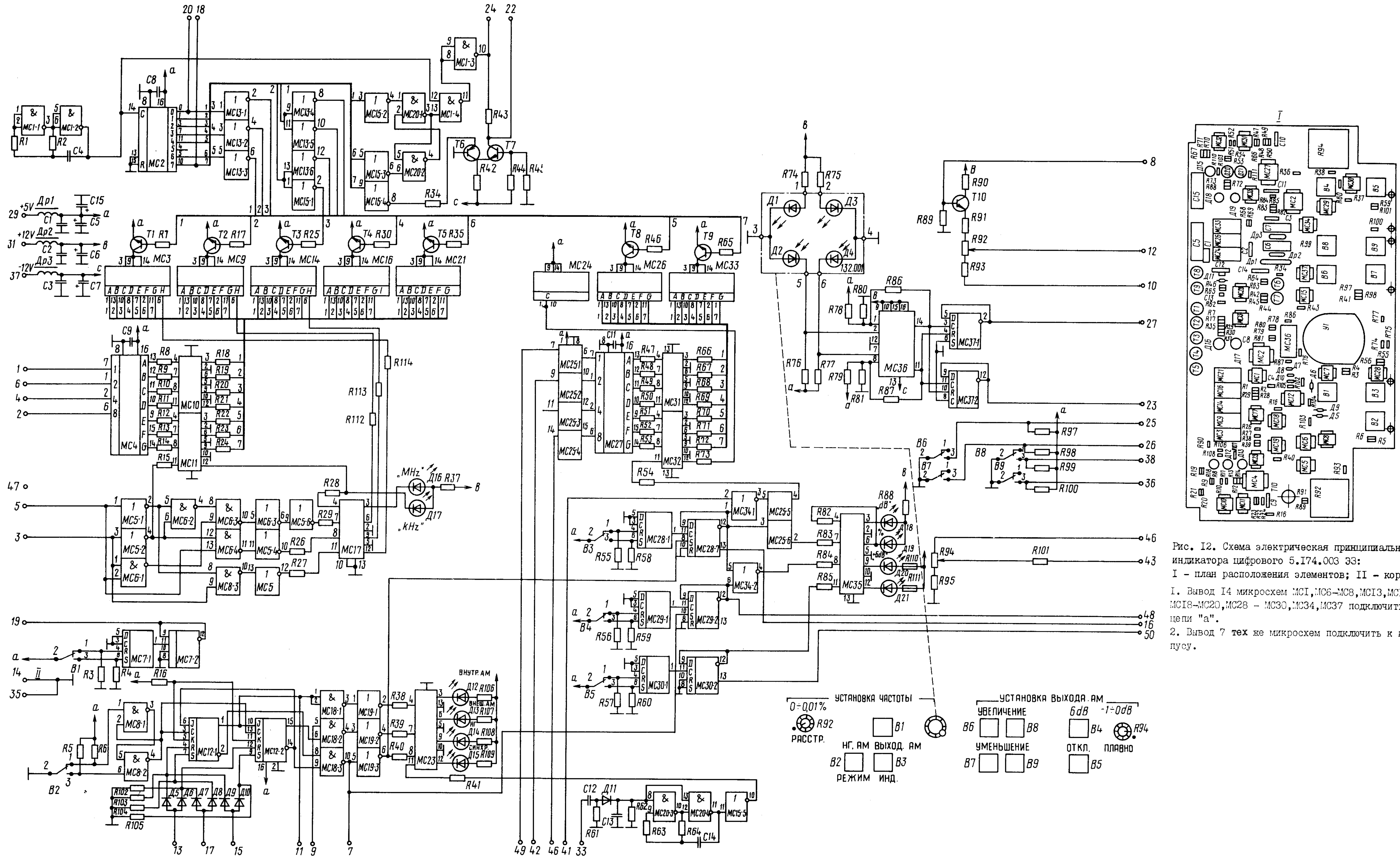
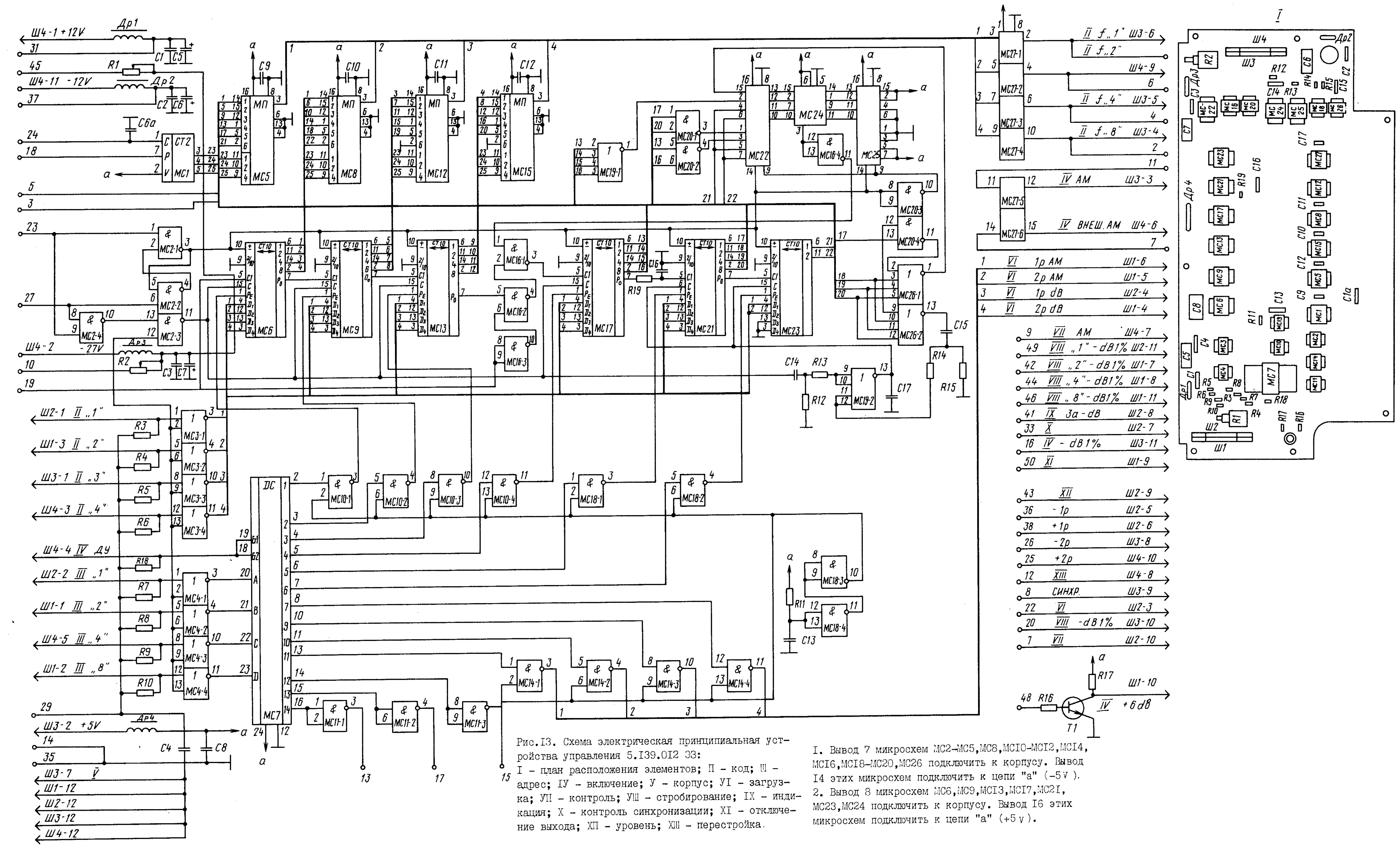


Рис. 12. Схема электрическая принципиальная индикатора цифрового 5.174.003 ЭЗ:
 I - план расположения элементов; II - кор I. Вывод 14 микросхем MC1, MC6-MC8, MC13, MC18-MC20, MC28-MC30, MC34, MC37 подключить к цепи "а".
 2. Вывод 7 тех же микросхем подключить к пуску.



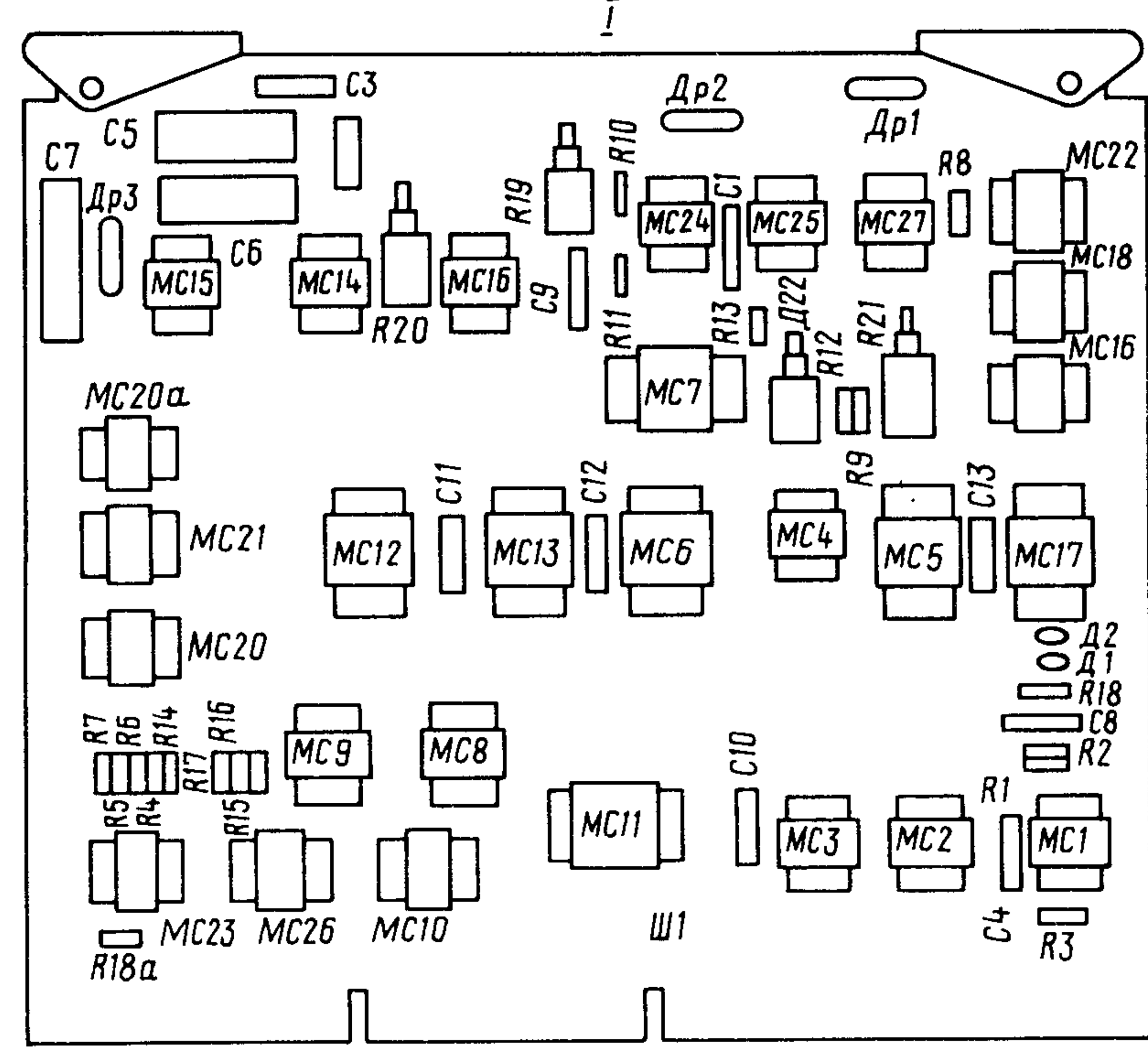
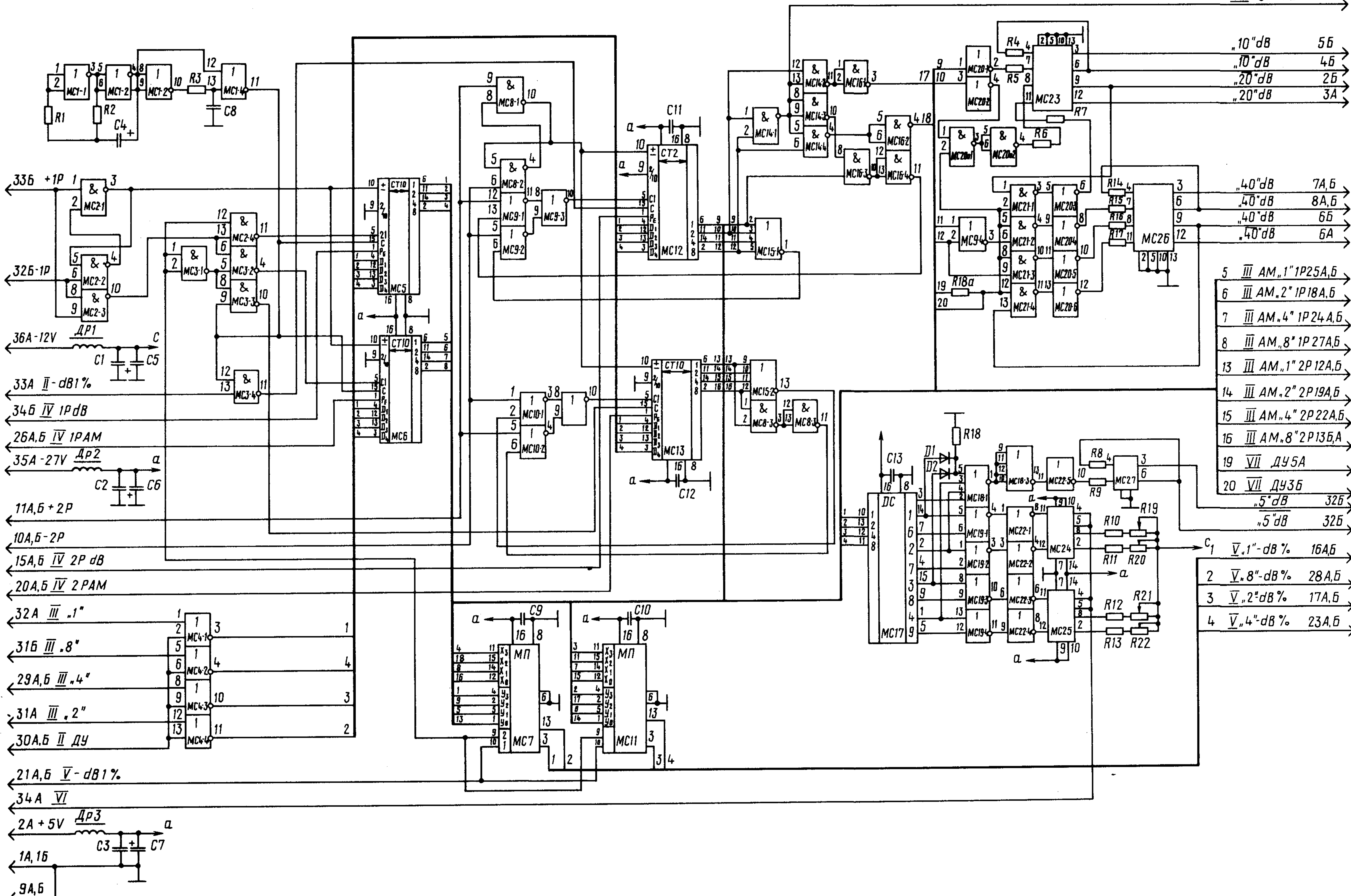


Рис.14. Схема электрическая принципиальная дешифратора выхода 5.109.003 ЭЗ:
I - план расположения элементов; II - включение; III - код; IV - загрузка; V - стробирование; VI - уровень; VII - отключение выхода; VIII - индикация
Вывод 7 микросхем MC1-MC4, MC8-MC10, MC14-MC16, MC18-MC22 подключить к корпусу, выводы I4 этих микросхем подключить к цепи "а" (+5V).